

智慧財產法院行政判決

106年度行專訴字第58號

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

原 告 吳美嬋

訴訟代理人 林哲誠律師

徐瑞毅律師

輔 佐 人 林聖剛

被 告 經濟部智慧財產局

代 表 人 洪淑敏（局長）

訴訟代理人 陳聖

參 加 人 日商斯克林半導體科技有限公司

代 表 人 後藤正人

訴訟代理人 陳寧樺律師

陳軍宇律師

鄭婷文專利師

輔 佐 人 金山 幸司（Koji KANEYAMA）

廣瀨 睦（Makoto HIROSE）

01

02 上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國10
03 6年6月23日經訴字第10606306100號訴願決定，提起行政訴訟
04 ，並經本院命參加人獨立參加本件被告之訴訟，本院判決如下：

05 主 文

06 訴願決定及原處分關於「請求項2至11、13至14、16至20舉發不
07 成立」部分均撤銷。

08 被告就發明第I394223號「基板處理裝置」專利舉發事件（0000
09 00000N01），應作成「請求項2至11、13至14、16至20舉發成立
10 ，撤銷專利權」之審定。

11 訴訟費用由被告負擔。

12 事實及理由

13 甲、程序方面：

14 本件參加人斯克林半導體科技有限公司之代表人原為須原忠
15 浩，嗣變更為後藤正人，經參加人於民國（下同）108年3
16 月14日具狀聲明承受訴訟（見本院卷四第80頁），經核並無
17 不合，應予准許。

18 乙、實體方面：

19 壹、事實概要：

20 緣參加人日商斯克林半導體科技有限公司（原名SOKUDO股份
21 有限公司）前於民國（下同）97年12月26日以「基板處理裝
22 置」向被告申請發明專利，同時主張優先權（受理國家：日
23 本，申請日：西元2007年12月28日，申請案號：0000-00000
24 0），經被告編為第97150911號審查，准予專利（申請專利
25 範圍共20項），發給發明第I394223號專利證書。嗣原告於
26 102年10月4日以該專利有違核准時（即102年1月1日施

01 行) 專利法第22條第2項規定，不符發明專利要件，對之提
02 起舉發。參加人則多次提出系爭專利申請專利範圍更正本。
03 案經被告審查，核認系爭專利104年10月8日更正本符合規
04 定，依該更正本審查，以105年10月14日(105)智專三(二)
05 04169字第10521258020號專利舉發審定書為「104年
06 10月8日之更正事項，准予更正」、「請求項2至11、13至
07 14、16至20舉發不成立」、「請求項1、12、15舉發駁回」
08 之處分。原告不服前揭處分中舉發不成立之部分，提起訴願
09 ，經濟部嗣以106年06月23日經訴字第10606306100號訴願
10 決定書作成訴願駁回之決定，原告仍未甘服，遂向本院提起
11 行政訴訟。本院認本件判決之結果，將影響參加人之權利或
12 法律上之利益，依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟。

13 貳、原告主張：

14 一、本院已將系爭專利的「試運轉」解釋為「以試驗、檢查、驗
15 證或確認處理單元對基板處理的品質或處理單元運作是否正
16 常為目的之運轉」；「系爭專利之相同之各步驟，係因不同
17 之試運轉或基板處理目的，而被分別認定為試運轉或通常運
18 轉之步驟」。由前述本院對系爭專利請求項中「試運轉」之
19 解釋可知，試運轉及通常運轉的步驟內容是相同的，僅有目
20 的之不同。參加人於107年9月13日所提更正之申請專利範
21 圍，僅是針對控制部所為之控制行為進一步作限定，對「試
22 運轉」本身並未有任何實質改變。

23 二、被告將請求項2分析為具有技術特徵1~6，並已自承原證4
24 (即舉發證據2)已揭露該技術特徵1、3、4、6，僅認
25 為原證4未能揭露該請求項之技術特徵2及5，準此，先前
26 技術原證4已揭露該請求項之技術特徵1、3、4、6之事

01 實，應為被告所不爭。

02 三、先前技術已揭露請求項2 之技術特徵2 ：

03 (一)系爭專利請求項2 之技術特徵2 為「控制部，針對每個基板
04 處理列而改變處理基板的步驟；」。

05 (二)原證4 之段落〔0134〕：「以其他處理列13對基板W 進行與
06 第1 處理不同之第2 處理」。原證4 既已明揭一含有進行不
07 同處理的不同處理列之基板處理裝置，則該基板處理裝置當
08 然會具有一「控制部」使得在同一基板處理裝置中的不同處
09 理列能夠進行不同處理。故原證4 已實質揭露請求項2 之技
10 術特徵2 。

11 (三)原證8 說明書第5 頁倒數第1 段：「迄今，由塗布顯像處理
12 裝置執行之基板處理流程的控制係例如由塗布顯像處理裝置
13 內之控制部來執行」。原證8 說明書第9 頁倒數第1 段至第
14 10 頁第1 段：「本發明之基板處理裝置係包含：搬入搬出部
15 ，係用以將基板搬入搬出；處理部，係用以進行前述基板之
16 處理；及檢查部，係用以進行前述基板之檢查，且，前述基
17 板處理裝置可在前述各部之間搬送前述基板，又，前述基板
18 處理裝置更具有在所述基板處理裝置中獨立地執行下列步驟
19 之控制部，且該等步驟包括：基板處理流程，係將業已搬入
20 前述搬入搬出部之前述基板搬送至前述處理部進行處理；及
21 基板檢查流程，係將業已搬入前述搬入搬出部之前述基板搬
22 送至前述檢查部進行檢查」。

23 (四)原證16 之摘要：「一種半導體晶圓處理機器之分配控制系統
24 ，含有主控制模組和複數應用控制模組。各應用控制模組和
25 主控制模組可獨立自主操作。主控制模組調整應用控制模組
26 的操作，而應用控制模組管制由晶圓處理機器進行的許多副

01 程序。…」原證16第2欄第30-33行：「本發明另一優點在
02 於提供一種控制系統，在單一連續運作中可以調整和控制不
03 同處理方略的應用」。原證16第14欄第20-28行：「例如，
04 除了此處描述之處理系統外，本發明原理亦可應用於任何數
05 量的工件處理系統。此外，分配控制系統可構成控制和調整
06 任何數量的不同系統功能和程序，而任何指定的應用控制模
07 組可構成控制任何數量和型的特殊操作。…」由上可知，
08 先前技術原證16所揭露之用於半導體晶圓處理之控制系統能
09 夠針對個別基板處理進行調整和控制不同處理方略的應用，
10 從而先前技術原證16已明確揭露及教示系爭專利請求項2之
11 技術特徵2「控制部，針對每個基板處理列而改變處理基板
12 的步驟」之技術內容。綜上，原證4已揭示一含有進行不同
13 處理的不同處理列之基板處理裝置，原證8已揭示藉由「控
14 制部」獨立進行「基板處理流程」及「基板檢查流程」之基
15 板處理裝置，原證5至7亦揭露一般基板處理裝置皆具備「
16 控制部」，原證16已揭示針對每個基板處理列而改變處理基
17 板的步驟之「控制部」，技藝人士自可輕易將原證5至8、
18 16之控制部應用於原證4之基板處理裝置，且無任何先天上
19 不相容之處。

20 四、先前技術已揭露或教示請求項2之技術特徵5：

21 (一)系爭專利請求項2之技術特徵5為「上述控制部在部分基板
22 處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他基板處
23 理列以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理
24 的品質或者用來試運轉處理單元之試運轉時之步驟處理基板
25 」。

26 (二)原證5段落【0015】：「在將基板朝一邊處理室搬送處理期

01 間，可進行另邊處理室相關之維修或條件變更。」所謂「將
02 基板朝一邊處理室搬送處理」當然可以是一般通常運轉的處
03 理程序另「進行另邊處理室相關之維修或條件變更」則當然
04 可以是系爭專利請求項2 技術特徵5 所謂「處理單元試驗、
05 檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉」。原證7 段
06 落【0002】：「在對基板進行既定處理之基板處理裝置中，
07 會在實際運作前進行用以確認其動作之試驗性運轉(動作測
08 試)。例如下述專利文獻1 中，會以修正基板處理裝置所設
09 定之基板處理條件為目的，實際對基板進行塗布形成光阻、
10 曝光處理及顯影處理來作為動作測試。」在正常動作前，進
11 行處理單元正常與否的動作測試乃屬習知技術，系爭專利所
12 屬技術領域之通常知識者當然可輕易完成「在不同處理列分
13 別進行通常運轉之處理與試運轉之處理」之技術特徵。

14 (三)原證8 說明書第6 頁第2 段：「在塗布顯像處理裝置之試運
15 轉時，必須進行用以調整處理部中之各處理單元的各種設定
16 等之調整作業或用以評定檢查部之精度等之評定作業」原證
17 8 說明書第7 頁倒數第1 段：「…該基板處理裝置係構成
18 為包含用以將基板搬入搬出之搬入搬出部、用以進行前述基板
19 之處理之處理部及用以進行前述基板之檢查之檢查部，且可
20 在前述各部之間搬送前述基板…前述基板處理裝置之控制方
21 法係獨立地執行下列步驟；基板處理流程，係將業已搬入前
22 述搬入搬出部之前述基板搬送至前述處理部進行處理；及基
23 板檢查流程，係將業已搬入前述搬入搬出部之前述基板搬送
24 至前述檢查部進行檢查」。原證8 上述內容與請求項2 技術
25 特徵5 相對應：搬入搬出部：對應於系爭專利之主搬送機構
26 處理之處理部：對應於系爭專利中通常運轉之處理列檢查之

01 檢查部：對應於系爭專利中試運轉之處理列基板處理流程：
02 對應於系爭專利中，部分基板處理列以通常運轉時之步驟處
03 理基板檢查流程：對應於系爭專利中，在其他基板處理列以
04 用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質
05 之試運轉時之步驟處理基板。原證8 說明書第8 頁第1 段：
06 「由於獨立地執行基板處理流程與檢查流程，因此，在基板
07 處理裝置之試運轉時，可執行基板檢查流程，並可將搬入搬
08 入搬出部之例如評定用基板直接搬送至檢查部進行檢查」、
09 「由於可同時進行基板之檢查流程及處理流程…」。是以系
10 爭專利技術特徵5 不僅已被原證8 所揭露，技藝人士更可基
11 於原證8 之揭露輕易完成「在不同處理列分別進行通常運轉
12 之處理與試運轉之處理」之技術特徵。

13 (四)原證16第1 欄第34-41 行：「…任何指定處理系統的效率 and
14 可靠性，直接涉及控制系統的設計和結構。此外，處理系統
15 的安裝、試驗、故障排除、維護等成本，亦直接關係到控制
16 系統的複雜性，以及控制系統如何與處理系統的各種功能性
17 組件和副系統作用。」原證16第2 欄第16-18 行：「因此，
18 本發明之優點在於提供一種改進控制系統，用於多功能半導體
19 處理系統」。原證16第2 欄第19-22 行：「本發明另一優
20 點在於提供一種控制系統，可提高多功能半導體處理系統的
21 效率、可靠性和堅固性。」原證16第2 欄第27-29 行：「分
22 配控制系統另一優點是，各副系統可單獨測試和診斷，而不
23 需整個處理系統進行動作。」原證16第2 欄第30-33 行：「
24 本發明另一優點在於提供一種控制系統，在單一連續運作中
25 可以調整和控制不同處理方略的應用。」原證16第2 欄第34
26 -37 行：「控制系統的又一優點是，可以平行方式控制和調

01 整各種副系統，因而減少停工時間，並增加晶圓產量」。原
02 證16第14欄第20-28行：「例如，除了此處描述之處理系統
03 外，本發明原理亦可應用於任何數量的工件處理系統。此外
04 ，分配控制系統可構成控制和調整任何數量的不同系統功能
05 和程序，而任何指定的應用控制模組可構成控制任何數量和
06 型式的特殊操作…」。原證16所揭露之用於半導體晶圓處理
07 之控制系統：針對個別基板處理進行調整和控制不同處理方
08 略的應用以平行方式控制和調整各種副系統使各副系統可「
09 同時進行」相同或不同之通常或特殊處理，其中各副系統同
10 時更可單獨進行測試、診斷，以減少停工時間並增加晶圓產
11 量。原證16所揭露對半導體處理系統之「單獨測試和診斷」
12 、「處理系統的安裝、試驗、故障排除、維護」等，即相當
13 於系爭專利請求項「用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基
14 板所進行處理的品質之試運轉」之處理步驟。原證16第14欄
15 第20-28行明確指出：「例如，除了此處描述之處理系統外
16 ，本發明原理亦可應用於任何數量的工件處理系統。此外，
17 分配控制系統可構成控制和調整任何數量的不同系統功能和
18 程序，而任何指定的應用控制模組可構成控制任何數量和型
19 式的特殊操作…」。換言之，原證16已明確揭露該發明之控
20 制系統可應用於任何數量的工件處理系統。故原證16已經揭
21 露「控制複數個晶圓處理系統之分配控制系統」之技術內容
22 ，不限於被告所宣稱之單一處理列。既然原證16已明確揭露
23 複數個處理系統之技術內容，則原證16所揭露之不僅能夠針
24 對個別基板處理進行調整和控制不同處理方略的應用，更可
25 以平行方式控制和調整各種副系統使各副系統可「同時進行
26 」相同或不同之通常或特殊處理，其中各副系統同時更可單

01 獨進行測試、診斷，以減少停工時間並增加晶圓產量。此外
02 ，原證16所揭露對半導體處理系統之「單獨測試和診斷」、
03 「處理系統的安裝、試驗、故障排除、維護」等，即完全相
04 當於系爭專利請求項2之技術特徵5。因此，原證16已明確
05 揭露及教示系爭專利請求項2之技術特徵5「上述控制部在
06 部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時在其
07 他基板處理列以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所
08 進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基板」之技術內容。

09 (五)關於系爭專利所欲解決之問題，系爭專利說明書指出：「…
10 在習知裝置中，難以針對每個基板改變對基板處理之步驟。
11 換言之，在習知裝置中，難以同時進行複數個步驟。」(參
12 原證3說明書第5頁)準此，系爭專利所欲解決之問題在於
13 「難以同時進行複數個基板處理步驟」。原證4所揭露之基
14 板處理裝置已可達成「對某個基板處理列進行第1處理，而
15 其他基板處理列進行第2處理」(參原證4段落【0134】)
16 ；原證8之基板處理裝置亦可達成同時進行「基板之檢查流
17 程及處理流程」(參原證8說明書第7頁最末段、第9頁最
18 末段至第10頁第1段等)；原證16之「多功能」半導體處理
19 系統可以「平行方式」控制和調整各種副系統使各副系統可
20 「同時進行」相同或不同之通常或特殊處理(參原證16說明
21 書第2欄第16-22及34-37行、第14欄第20-28行)。所屬
22 技術領域中具有通常知識者有動機結合原證4、8或4、16
23 或4、8、16或4至6或4至7所揭示內容而輕易完成系爭
24 專利請求項2之技術特徵。

25 五、參加人在答辯(五)狀中，辯稱原告所提出之引證案並未揭
26 露系爭專利請求項2之技術特徵3「複數基板處理列」之「

01 上下方向排列設置」之技術特徵云云。惟系爭專利說明書第
02 51頁倒數第2段提及「…雖基板處理列」在上下方向排列而
03 設置，但不受限於此。例如，亦可變更為具備有在橫向或水
04 平方向排列設置的複數個基板處理列」」。可知系爭專利基
05 板處理裝置之基板處理列，在排列上並非一定要是上下排列
06 者。由此可知，將基板處理列排列於上下方向並非有特殊貢
07 獻之特別技術特徵。且藉由將物體進行上下方向的排列可減
08 少佔地面積，本係系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者
09 在系爭專利申請時均可輕易思及，故複數基板處理列進行上
10 下方向排列，並不具有不可預期之技術特徵。參加人另援引
11 參證4至7來強調系爭專利申請當時塗佈顯影裝置所遇到的
12 種種課題，如需降低成本等云云。然而，系爭專利請求項之
13 文字根本未限定系爭專利須為塗布顯影裝置。至於系爭專利
14 說明書中所記載之塗布顯影裝置，充其量不過是一實施例，
15 根本不得用以限定系爭專利請求項之範圍。故參加人之辯詞
16 不足採信。

17 六、系爭專利請求項2至4、6至11相較於如下先前技術之組合
18 不具進步性：原證4、8之組合；原證4、5、6之組合；
19 ；原證4、5、6、7之組合；原證4、16之組合；或原證
20 4、8、16之組合。系爭專利請求項5、13至14、16至20相
21 較於如下先前技術之組合不具進步性：原證4、6、8之組
22 合；原證4、5、6之組合；原證4、5、6、7之組合；
23 原證4、6、16之組合；或原證4、6、8、16之組合。系
24 爭專利以空洞而不具具體控制技術或控制程式的請求項便能
25 主張其不當獲得之專利權，將使得相關業者無所適從，有違
26 我國專利法之立法意旨，若讓系爭專利權得以維持，將有礙

01 於我國半導體產業之發展，甚至阻礙半導體處理裝置的機台
02 研究開發。

03 七、系爭專利韓國對應案（即韓國第1170211 號專利）已遭韓國
04 專利審判院基於本案原告所提完全相同之先前技術組合認定
05 為無效（原證11）：

06 以韓國對應案的請求項1 為例，該請求項除了完全對應系爭
07 專利請求項2 之技術特徵1-5 外，尚額外限定了原處分及原
08 訴願決定針對系爭專利的請求項5 所分析之技術特徵8 、9
09 、10、11，亦即，韓國對應案之請求項1 之範圍小於系爭專
10 利請求項2 ，惟韓國專利審判院仍依本案原證4 、原證5 及
11 原證6 的組合，認定該韓國專利請求項1 不具進步性而無效
12 ，此益證系爭專利確有不具進步性之情事而應予撤銷。

13 八、並聲明：1.原訴願決定撤銷。2.原處分主文第二項「請求項
14 2 至11、13至14、16至20舉發不成立」應撤銷，並命被告另
15 為「請求項2 至11、13至14、16至20舉發成立，應予撤銷」
16 之處分。3.訴訟費用由被告負擔。

17 參、被告答辯：

18 一、原證4 、8 之組合、原證4 、16之組合、原證4 、8 、16之
19 組合、原證4 至6 之組合、原證4 至7 之組合不足以證明系
20 爭專利請求項2 至4 、6 至11不具進步性：

21 (一)原證4 、8 之組合不足以證明系爭專利請求項2 不具進步性
22 ：

23 (1)舉發審定書第7 頁的分析表格已敘明請求項2 先與原證4
24 比對，比對結果是原證4 並未明示有控制部的存在（技術
25 特徵2 ），且未記載控制部及其限制的動作條件（技術特
26 徵5 ）。原證4 未說明第1 處理或第2 處理之何者用於確

01 認品質之處理，為何原證4 所揭示之第1 處理及第2 處理
02 可輕易思及並完成第1 處理為通常處理，第2 處理為試運
03 轉之指定，且僅以原證4 之記載，完全未提及任何試運轉
04 技術的教導或暗示，難稱原證4 已隱含有控制部可進行試
05 運轉的技術，原告所言原證4 已隱含控制部及其限制的動
06 作（技術特徵5 ）應無可採。

07 (2)原證8 雖於第5 頁第19行記載有「控制部」一詞，但由原
08 告所列舉原證8 的出處（第5 、7 、9 、10頁）記載之處
09 理部與檢查部可發現，原證8 檢查部無法比對為系爭專利
10 之「通常運轉之處理列」與「試運轉之處理列」，原因在
11 於系爭案的「通常運轉之處理列」與「試運轉之處理列」
12 皆為基板處理列，皆可對基板執行複數種類之處理；反觀
13 ，原證8 之檢查部僅能對基板執行檢查，並未記載檢查部
14 可對基板執行複數種類之處理，顯然不能將檢查部比對為
15 系爭專利請求項1 之技術特徵1 之基板處理列，故原證8
16 第8 頁雖記載「由於獨立地執行基板處理流程與檢查流程
17 ，因此，在基板處理裝置之試運轉時，可執行基板檢查流
18 程，並可將搬入搬入搬出部之例如評定用基板直接搬送至
19 檢查部進行檢查」，此記載不相當於系爭專利請求項1 技
20 術特徵5 記載「上述控制部在部分基板處理列以通常運轉
21 時之步驟處理基板，並同時在其他基板處理列以用來使處
22 理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運
23 轉時之步驟處理基板」。

24 (3)綜上，由於系爭專利請求項2 之技術特徵5 並未被原證8
25 所揭露，且原證8 僅具有單一的基板處理列，即便原證8
26 有揭露控制部，仍無法證明原證4 、8 結合後控制部可執

01 行系爭專利請求項2 技術特徵5 ，故原證4 、8 之組合不
02 足以證明系爭專利請求項2 違反專利法第22條第2 項之規
03 定。

04 (二)原證4 至6 之組合不足以證明系爭專利請求項2 不具進步性
05 :

06 (1)原證4 並未明示有控制部的存在 (技術特徵2) ，且未記
07 載控制部及其限制的動作條件 (技術特徵5) 。

08 (2)原證5 第 [0019] 段的節譯文內容記載複數個處理室12a
09 、12b 僅利用蒸發源作蒸鍍處理 (單一種製程步驟) ，將
10 其複數個處理室比對為系爭專利的可執行複數種類製程處
11 理之複數個基板處理列並不恰當，故原證5 圖2 與原證4
12 的裝置應並不相容；其次，原證5 進行處理室相關之維修
13 或條件的變更，如第 [0029] 段記載是為了設備維護或蒸
14 發源材料補充、清掃等做的處理，第 [0046] 段記載是為
15 了在不同基板需要不同的成膜條件的測試，原證5 維修或
16 條件的變更難謂是為了試驗、驗證、確認該處理單元對基
17 板所進行的處理品質。因此，原證5 未揭露技術特徵5 中
18 的試運轉。

19 (3)另有關原證5 的控制裝置，請求項2 記載的控制部可針對
20 每個基板處理列改變處理基板的步驟，參照系爭專利說明
21 書第5 頁末段內容，…可根據所搬送的基板處理列，而針
22 對每個基板較佳地改變對基板進行的處理步驟，系爭專利
23 應解讀為具有對每個基板處理列 (上的每個基板) 改變對
24 基板進行的處理步驟，亦可參照系爭專利第18頁及圖2 的
25 Lu、Ld 二者步驟相異，及Lu/Ld 步驟相異的情況。然而，
26 參照原告提供之原證5 第 [0022] 段的節譯文內容，原證

01 5 第〔0022〕段所記載的「基於控制裝置的指示」是要選
02 擇將基板分送至12a、12b任一目的地做指示，非對改變
03 處理基板的步驟做指示，故原證5的控制裝置所執行的動
04 作與系爭專利不同，所以原證5所記載的控制裝置難以與
05 原證4所揭露的基板處理列動作組合。

06 (4)原證6的半導體基板處理系統10僅包含單一產線，非如同
07 系爭專利的複數條處理列，雖說原證6可以在該單一產線
08 執行試運轉，但是無法說明原證6的控制部可在複數條處
09 理列的情況下，會將部分基板處理列以通常運轉時之步驟
10 處理基板，並同時在其他基板處理列以用來使處理單元試
11 驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之步
12 驟處理基板的動作，原證6仍未揭示技術特徵5。

13 (5)由於原證5所記載的控制裝置與原證4並不相容，且原證
14 4至6皆未揭示技術特徵5的情況下，原證4至6之組合
15 不足以證明系爭專利請求項2違反專利法第22條第2項之
16 規定。

17 (三)原證4至7之組合不足以證明系爭專利請求項2不具進步性
18 :

19 (1)原證7並未揭露如何達成技術特徵2的控制部，可針對每
20 個基板處理列而改變處理基板的步驟，也未揭露如何達成
21 技術特徵5的「在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處
22 理基板，並同時在其他基板處理列以用來使處理單元試驗
23 、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟
24 處理基板。」，故原證7並未揭示原證4所欠缺技術特徵
25 2、5的內容。

26 (2)由於原證5記載的內容與原證4並不相容，且原證6與原

01 證7 皆未揭示技術特徵5 的情況下，原證4 至7 不足以證
02 明系爭專利請求項2 違反專利法第22條第2 項之規定。

03 (四) 原證4 、16或原證4 、8 、16之組合不足以證明系爭專利請
04 求項2 不具進步性：

05 (1) 原證4 、8 、16都未揭露請求項2 之「上述控制部在部分
06 基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他
07 基板處理列以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所
08 進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基板」技術特徵。

09 (2) 系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者於參酌原證4 、
10 8 、16所揭露之技術內容，應無法經由簡單組合上述原證
11 ，而輕易完成系爭專利請求項2 之發明，故原證4 、16或
12 原證4 、8 、16之組合不足以證明系爭專利請求項第2 項
13 違反專利法第22條第2 項之規定。

14 (五) 原證4 、8 之組合不足以證明系爭專利請求項3 不具進步性
15 ：

16 (1) 請求項3 具有與請求項2 相同的技術特徵1 至5 ，原證
17 4 亦未揭示請求項2 之技術特徵2 、5 ，故原證4 亦未揭
18 示請求項3 技術特徵2 、5 ，請求項3 更附加技術特徵7
19 ，原證4 並未明示有控制部的存在，也無法完成技術特徵
20 7 的動作。

21 (2) 由於系爭專利請求項3 之技術特徵5 並未被原證8 所揭露
22 ，且原證8 僅具有單一的基板處理列，即便原證8 有揭露
23 控制部，仍無法證明原證4 、8 結合後控制部可執行系爭
24 專利請求項3 技術特徵5 、7 ，故原證4 、8 之組合不足
25 以證明系爭專利請求項3 違反專利法第22條第2 項之規定
26 。

01 (六) 原證4 至6 之組合不足以證明系爭專利請求項3 不具進步性
02 :

03 請求項3 具有與請求項2 相同的技術特徵1 至5 ，因此原證
04 4 至6 之組合並未揭示請求項3 技術特徵2 、5 ，請求項3
05 更附加技術特徵7 ，原證4 並未揭示技術特徵7 的動作，故
06 原證4 至6 之組合不足以證明系爭專利請求項3 違反專利法
07 第22條第2 項之規定。

08 (七) 原證4 至7 之組合不足以證明系爭專利請求項3 不具進步性
09 ;

10 請求項3 具有與請求項2 相同的技術特徵1 至5 ，因此原證
11 4 至7 之組合並未揭示請求項3 技術特徵2 、5 ，請求項3
12 更包括技術特徵7 ，原證4 並未揭示技術特徵7 的動作，故
13 原證4 至7 之組合不足以證明系爭專利請求項3 違反專利法
14 第22條第2 項之規定。

15 (八) 原證4 與原證8 、原證4 至6 、原證4 至7 等組合不足以證
16 明系爭專利請求項4 不具進步性：

17 請求項4 係請求項3 之附屬項，包括請求項3 相同的技術特
18 徵1 至5 ，原證4 與原證8 、原證4 至6 、原證4 至7 等組
19 合不足以證明系爭專利請求項3 不具進步性，故上開組合亦
20 不足以證明系爭專利請求項4 違反專利法第22條第2 項之規
21 定。

22 (九) 原證4 、8 之組合不足以證明系爭專利請求項6 不具進步性
23 :

24 (1) 請求項6 具有與請求項2 相同的技術特徵1 至5 ，原證4
25 並未揭示請求項2 之技術特徵2 、5 ，故亦未揭示請求項
26 6 技術特徵2 、5 ，請求項6 更包括技術特徵12，原證4

01 並未明示有控制部的存在，也無法完成技術特徵12的動作
02 。

03 (2)由於系爭專利請求項6之技術特徵5並未被原證8所揭露
04 ，且原證8僅具有單一的基板處理列，即便原證8有揭露
05 控制部，仍無法證明原證4、8結合後控制部可執行系爭
06 專利請求項6技術特徵5、12，故原證4、8之組合不足
07 以證明系爭專利請求項6違反專利法第22條第2項之規定
08 。

09 (十)原證4至6之組合不足以證明系爭專利請求項6而不具進步
10 性：

11 請求項6具有與請求項2相同的技術特徵1至5，原證4至
12 6之組合並未揭示請求項2技術特徵2、5，故亦未揭示請
13 求項2技術特徵2、5，請求項6更附加技術特徵12，原證
14 4並未揭示技術特徵12的動作，故原證4至6之組合不足以
15 證明系爭專利請求項6違反專利法第22條第2項之規定。

16 (十一)原證4至7之組合不足以證明系爭專利請求項6不具進步性
17 ：

18 請求項6具有與請求項2相同的技術特徵1至5，原證4至
19 7之組合並未揭示請求項2技術特徵2、5，故亦未揭示請
20 求項6技術特徵2、5，請求項6更包括技術特徵12，原證
21 4並未揭示技術特徵12的動作，故原證4至7之組合不足以
22 證明系爭專利請求項6違反專利法第22條第2項之規定。

23 (十二)原證4與原證8、原證4至6、原證4至7等組合不足以證
24 明系爭專利請求項7不具進步性：

25 請求項7係請求項6之附屬項，包括請求項6相同的技術特
26 徵1至5，因此原證4與原證8、原證4至6、原證4至7

01 等組合皆不足以證明系爭專利請求項7 違反專利法第22條第
02 2 項之規定。

03 (十三) 原證4 、8 之組合不足以證明系爭專利請求項8 不具進步性
04 :

05 (1) 請求項8 具有與請求項2 相同的技術特徵1 至5 ，因此原
06 證4 並未揭示請求項8 技術特徵2 、5 ，原證4 並未揭示
07 請求項2 技術特徵2 、5 ，故亦未揭示請求項8 技術特徵
08 2 、5 ，請求項6 更包括技術特徵13，原證4 並未明示有
09 控制部的存在，也無法完成技術特徵13的動作。

10 (2) 由於系爭專利請求項8 之技術特徵5 並未被原證8 所揭露
11 ，且原證8 僅具有單一的基板處理列，即便原證8 有揭露
12 控制部，仍無法證明原證4 、8 結合後控制部可執行系爭
13 專利請求項8 技術特徵5 、13，故原證4 、8 之組合不足
14 以證明系爭專利請求項8 違反專利法第22條第2 項之規定
15 。

16 (十四) 原證4 至6 之組合不足以證明系爭專利請求項8 不具進步性
17 :

18 請求項8 具有與請求項2 相同的技術特徵1 至5 ，因此原證
19 4 至6 之組合並未揭示請求項8 技術特徵2 、5 ，請求項8
20 更包含技術特徵13，原證4 並未揭示技術特徵13的動作，故
21 原證4 至6 之組合不足以證明系爭專利請求項8 違反專利法
22 第22條第2 項之規定。

23 (十五) 原證4 至7 之組合不足以證明系爭專利請求項8 不具進步性
24 :

25 請求項8 具有與請求項2 相同的技術特徵1 至5 ，因此原證
26 4 至7 之組合並未揭示請求項8 技術特徵2 、5 ，請求項8

01 更包括技術特徵13，原證4 並未揭示技術特徵13的動作，故
02 原證4 至7 之組合不足以證明系爭專利請求項8 違反專利法
03 第22條第2 項之規定。

04 (十六)原證4 與原證8 、原證4 至6 、原證4 至7 等組合不足以證
05 明系爭專利請求項9 不具進步性：

06 請求項9 係請求項8 之附屬項，包括請求項8 相同的技術特
07 徵1 至5 ，因此原證4 與原證8 、原證4 至6 、原證4 至7
08 等組合皆不足以證明系爭專利請求項9 違反專利法第22條第
09 2 項之規定。

10 (十七)原證4 、8 之組合不足以證明系爭專利請求項10不具進步性
11 ：

12 (1)請求項10具有與請求項2 相同的技術特徵1 至5 ，因此原
13 證4 並未揭示請求項10技術特徵2 、5 ，請求項10更包括
14 技術特徵14，原證4 並未明示有控制部的存在，也無法完
15 成技術特徵14的動作。

16 (2)由於系爭專利請求項10之技術特徵5 並未被原證8 所揭露
17 ，且原證8 僅具有單一的基板處理列，即便原證8 有揭露
18 控制部，仍無法證明原證4 、8 結合後控制部可執行系爭
19 專利請求項8 技術特徵10、14，故原證4 、8 之組合不足
20 以證明系爭專利請求項10違反專利法第22條第2 項之規定
21 。

22 (十八)原證4 至6 之組合不足以證明系爭專利請求項10不具進步性
23 ：

24 請求項10具有與請求項2 相同的技術特徵1 至5 ，因此原證
25 4 至6 之組合並未揭示請求項10技術特徵2 、5 ，請求項10
26 更包含技術特徵14，原證4 並未揭示技術特徵14的動作，故

01 原證4 至原證6 之組合不足以證明系爭專利請求項10違反專
02 利法第22條第2 項之規定。

03 (十九)原證4 至7 之組合不足以證明系爭專利請求項10不具進步性
04 :

05 請求項10具有與請求項2 相同的技術特徵1 至5 ，因此原證
06 4 至7 之組合並未揭示請求項10技術特徵2 、5 ，請求項10
07 更包括技術特徵14，原證4 並未揭示技術特徵14的動作，故
08 原證4 至7 之組合不足以證明系爭專利請求項10違反專利法
09 第22條第2 項之規定。

10 (二十)原證4 與原證8 、原證4 至6 、原證4 至7 等組合不足以證
11 明系爭專利請求項11不具進步性：

12 請求項11係請求項10之附屬項，包括請求項10相同的技術特
13 徵1 至5 ，因此原證4 與原證8 、原證4 至6 、原證4 至7
14 等組合皆不足以證明系爭專利請求項11違反專利法第22條第
15 2 項之規定。

16 二、原證4 、6 、8 之組合、原證4 、6 、16之組合、原證4 、
17 6 、8 、16之組合、原證4 至6 之組合、原證4 至7 之組合
18 不足以證明系爭專利請求項5 、13至14、16至20不具進步性
19 之理由，詳如答辯書所載。

20 三、原處分未違反專利法第73條第4 項之規定：

21 (一)試運轉一詞為舉發階段兩造所爭執，原處分已對試運轉一詞
22 做界定，參考的內容以申請專利範圍及說明書的記載為主。

23 (二)兩造對試運轉之爭執內容及後續衍生內容，包括原告103 年
24 12月5 日舉發補充理由爭執試運轉之處理單元是否是一種實
25 施形態，及參加人104 年10月8 日被舉發補充答辯理由書第
26 4 頁(2)的內容，如「維修時要先把電源關掉」、「操作

01 者不得以手動方式搬送基板」、「系爭案可把基板自動地搬
02 送」等，經審酌皆非系爭案申請專利範圍之記載，且後續原
03 告於104年10月20日對此提出補充證據，亦與試運轉的意義
04 不同，故原處分未違反專利法第73條第4項之規定。

05 四、並聲明：1.駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。

06 肆、參加人之陳述：

07 一、原告提出之證據，並未揭露系爭專利之主要技術特徵：

08 (一)系爭專利之主要技術特徵²：「控制部，針對每個基板處理
09 列而改變處理基板的步驟」；技術特徵³：「於上下方向排
10 列設置上述複數個基板處理列」；技術特徵⁵：「上述控制
11 部在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時
12 在其他基板處理列藉由改變處理基板的步驟以用來使處理單
13 元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之
14 步驟處理基板」，均未為引證案所揭露。

15 (二)原證⁴〔0134〕段僅提及「以其他處理列¹³對基板^W進行與
16 第¹處理不同之第²處理」。惟並未揭露「第¹處理」、「
17 第²處理」係進行何種處理，亦未揭露如何「針對每個基板
18 處理列而改變處理基板的步驟」，更未揭露「如何」同時控
19 制複數個基板處理列，以進行通常運轉及試運轉。故原證⁴
20 並未揭露技術特徵²可以「改變處理基板的步驟」的「控制
21 部」及技術特徵⁵「在其他基板處理列藉由改變處理基板的
22 步驟」，在複數個基板處理列同時進行不同程序之「通常運
23 轉」與「試運轉」。原證⁵僅為具有²個分別僅進行相同種
24 類的單一成膜處理的處理室的「真空成膜裝置」，並未揭露
25 「改變處理基板的步驟」。原證⁶僅為單一產線的基板處理
26 裝置，並未揭露「改變處理基板的步驟」。原證⁷僅為單一

01 產線的基板處理裝置，並未揭露「改變處理基板的步驟」。
02 原證8 僅為單一產線的基板處理裝置，並未揭露「改變處理
03 基板的步驟」。原證16 僅為CMP（化學機械研磨）的單一產
04 線，並未揭露「改變處理基板的步驟」。且原告提出之引證
05 多為「單一產線」，並非如同系爭專利的複數條處理列，組
06 合原證4 與「單一產線」引證，並未揭露技術特徵2 可以「
07 改變處理基板的步驟」的「控制部」，亦未揭露技術特徵5
08 「在其他基板處理列藉由改變處理基板的步驟」，在複數個
09 基板處理列同時進行不同程序之「通常運轉」與「試運轉」
10 。

11 (三) 系爭專利「上下方向排列設置」的「複數個基板處理列」之
12 架構，必須克服下列技術問題：防止「增大佔地面積」、抑
13 制「基板處理裝置的高度」、解決搬送裝置在空間中移動時
14 ，產生的「顆粒（particle，灰塵）污染基板」問題。

15 二、關於請求項2 的主張：

16 (一) 原證4 [0134] 段，僅僅提及兩條處理列可以進行不同處理
17 ；原證4 對於「針對每個基板處理列而改變處理基板的步驟
18 」沒有具體的記載，因此，原證4 並未揭示可以改變處理基
19 板的步驟的「控制部」。原證4 [0134] 段沒有記載或教示
20 「在其他基板處理列藉由改變處理基板的步驟」，在複數個
21 基板處理列同時進行不同程序之「通常運轉」與「試運轉」
22 ，亦未揭露「技術特徵3 」：於上下方向排列設置上述複數
23 個基板處理列，故原證4 並未揭露技術特徵2 、3 、5 。

24 (二) 原證5 [0015] 段，僅揭露2 個分別進行相同種類的單一成
25 膜處理的處理室12a 、12b 的真空成膜裝置分別在處理室
26 12a 、12b 僅進行「單一成膜處理」，根本不存在「改變處

01 理基板步驟」的概念。原證5 [0046]段所謂的「條件引出
02 」、是為了決定「單一成膜處理」中，壓力等參數的新製程
03 的生產條件，其與系爭專利「藉由改變處理基板的步驟」的
04 「試運轉」並不相同。

05 (三)原證6 是「單一產線」，根本就沒有揭露「複數個基板處理
06 列」，因此，未揭露「在部分基板處理列以通常運轉時之步
07 驟處理基板，並同時在其他基板處理列以試運轉時之步驟處
08 理基板」。

09 (四)原證7 是「單一產線」，原證7 [0002]段沒有記載或教示
10 「在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時
11 在其他基板處理列藉由改變處理基板的步驟」「以試運轉時
12 之步驟處理基板」，因此，原證7 未揭露技術特徵5 。

13 (五)原證8 是「單一產線」，原證8 圖4 的檢查站3 具備檢查單
14 元20-22 及晶圓搬送裝置12，該檢查單元20-22 是檢查基板
15 ，並不「處理基板」，只是進行檢查，不是複數種處理；是
16 以，原證8 的檢查單元20-22 不相當於系爭專利的「處理單
17 元」，原證8 的檢查站3 不能相當於系爭專利的「基板處理
18 列」，原證8 第7 頁至第9 頁的內容並未揭露改變處理站4
19 處理晶圓W 的步驟，原證8 的控制部120 並不改變處理站4
20 處理基板的步驟，因此，原證8 並未揭露技術特徵2 、技術
21 特徵5 ，原證8 第11頁第2 段的檢查流程，僅作「檢查」工
22 作而不「處理基板」，亦不進行「複數種類處理」，並未揭
23 露「改變處理基板的步驟」。

24 (六)原證16是CMP 的「單一產線」，原證16僅揭露一邊從載台
25 102 至載台112 搬送各基板，一邊在載台102 至載台112 全
26 體對基板進行一連串的處理，即使載台102 -112全體類似於

01 「技術特徵1」的「基板處理列」的1個，原證16亦未揭露
02 系爭專利的「複數個基板處理列」。原證16並未揭露系爭專
03 利的「改變處理基板的步驟」，原證16所揭露者為在單一種
04 類的CMP加工中調整如下壓力的參數，即在一個載台處理單
05 元內調整參數等，例如，僅揭露以CMP加工、洗淨、沖洗、
06 乾燥的順序進行，並未揭露「改變CMP加工、洗淨、沖洗、
07 乾燥的順序」。

08 三、關於請求項5的主張：

09 (一)系爭專利請求項5進一步附加技術特徵8至技術特徵11，關
10 於「輸入部」、「輸入部」與「控制部」之間的互動關係。
11 原證4、原證5、原證6、原證7、原證8、原證16並未揭
12 露「輸入部」，即未揭露技術特徵8至技術特徵11。

13 (二)原證6具有一操作部20，惟原證6並未揭露系爭專利的「複
14 數基板處理列」，因此，該操作部20無法「輸入用以『對每
15 個基板處理列』設定之資訊，原證6未揭露「技術特徵8」
16 。原證6未揭露系爭專利的「複數個基板處理列」，因此未
17 揭露技術特徵9「上述控制部係根據輸入至『上述輸入部』
18 之資訊，改變『各基板處理列』的搬送路徑」。原證6並未
19 揭露輸入操作部20的資訊，是特定進行試運轉之處理單元的
20 資訊，因此，原證6全然未揭露關於技術特徵10。技術特徵
21 11「上述控制部係根據特定進行試運轉之處理單元的資訊，
22 決定將基板僅搬送至所特定之處理單元的搬送路徑」，是用
23 於更詳細地具體化「技術特徵5」之「控制內容」的特徵；
24 由於原證6未揭露系爭專利的技術特徵5，故原證6亦未揭
25 露或教示技術特徵11。

26 四、原告提出之引證之組合，均不足以否定系爭專利請求項2至

01 11、13至14、16至20之進步性。系爭專利「複數個基板處理
02 列」的基板處理裝置，為半導體重要製程裝置，是為了因應
03 「曝光裝置」性能大幅提升、價格飛漲，半導體廠商需要半
04 導體元件源源不絕地被製造，需要提高機台稼動率而生。「
05 曝光裝置」攸關半導體元件功能中決定各層導線寬度的設備
06 ，2010年間之價格，乾式曝光機價值3億歐元左右，浸潤式
07 曝光機價值65億歐元左右（參證5）系爭專利為物理、化學
08 、光學、流體力學等高科技技術的集合體，考量系爭專利技
09 術內容應「整體」觀之，確實考量技術實質內涵及難度，不
10 可用零碎的解讀方式，將「控制部」、「基板處理列」等元
11 件片面比對。

12 五、並聲明：1.駁回原告之訴。2.訴訟費用由原告負擔。

13 伍、本件之爭點（見本院卷三第18頁）：

14 一、原證4、8之組合、原證4、16之組合、原證4、8、16之
15 組合、原證4至6之組合、原證4至7之組合是否足以證明
16 系爭專利請求項2至4、6至11不具進步性？

17 二、原證4、6、8之組合、原證4、6、16之組合、原證4、
18 6、8、16之組合、原證4至6之組合、原證4至7之組合
19 是否足以證明系爭專利請求項5、13至14、16至20不具進步
20 性？

21 三、原處分及訴願決定是否違反核准審定時專利法第73條第4項
22 規定？

23 陸、得心證之理由：

24 一、本件應適用之專利法：

25 系爭專利申請日為97年12月26日，核准審定日為102年2月
26 21日，其是否有應撤銷專利權之情事，應以核准審定時所適

01 用之100 年12月21日修正公布、102 年1 月1 日施行之專利
02 法（下稱100 年專利法）為斷。按凡利用自然法則之技術思
03 想之創作，而可供產業上利用者，得依法申請取得發明專利
04 ，固為系爭專利核准時專利法第21條及第22條第1 項前段所
05 規定。惟發明如為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請
06 前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利，復為
07 同法第22條第2 項所明定。

08 二、本院得審酌原告提出之原證8 、原證16：

09 按關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當
10 事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證
11 據，智慧財產法院仍應審酌之，智慧財產案件審理法第33條
12 第1 項定有明文。原告於原處分階段，僅提出原證4 至7 （
13 即舉發證據2 至5 ），主張上開證據之組合，足以證明系爭
14 專利請求項第2 至11、12，13至14、16至20不具進步性，嗣
15 於本件行政訴訟階段，始提出原證8 、原證16，主張原證8
16 、原證16分別與原證4 至7 之組合，足以證明系爭專利請求
17 項請求項第2 至11、12，13至14、16至20不具進步性，乃就
18 同一撤銷理由所提之新證據，並經被告就該新證據提出答辯
19 ，依智慧財產案件審理法第33條第1 項規定，本院就上開新
20 證據，得併予審究。至於原告提出之原證23、24（系爭專利
21 優先權日前之通常知識），係兩造於108 年1 月23日準備程
22 序，已就系爭專利之有效性進行技術簡報並互為攻防完畢之
23 後，遲至108 年5 月16日始提出，並經參加人以原告逾時提
24 出攻擊防禦方法之情事，提出異議，按行政訴訟法第132 條
25 準用民事訴訟法第276 條第1 項規定：「未於準備程序主張
26 之事項，除符合該條項第1 至4 款規定外，於準備程序後行

01 言詞辯論時，不得主張之」，本院認為原告提出原證23、24
02 確已違反行政訴訟法第132條準用民事訴訟法第276條第
03 1項之規定，依上開規定，應不予審酌。

04 三、系爭專利技術分析：

05 (一)系爭專利之先前技術：

06 習知基板處理裝置，具有以下問題，例如，有時會想在一部
07 分處理單元進行試運轉，同時在其他處理單元對基板進行一
08 連串處理。或者，有時會想對一部分基板進行形成阻劑膜用
09 及將基板顯像用之步驟，同時對其他基板進行形成阻劑膜用
10 之步驟。此處所謂「步驟」，可由種類不同之複數個處理所
11 構成，亦可由單一處理所構成。然而，若步驟在基板間具有
12 不同步驟，則基板相對於各種處理單元的搬送路徑會改變。
13 因此，主搬送機構無法有效率地搬送基板。因此，在習知裝
14 置中，難以針對每個基板改變對基板處理之步驟。換言之，
15 在習知裝置中，難以同時進行複數個步驟。

16 (二)系爭專利發明內容：

17 (1)本發明有鑑於此而完成，其目的在於提供一種可針對每個
18 基板改變對基板處理之步驟而可同時進行2個以上不同步
19 驟之處理的基板處理裝置。上述控制部最好可使部分基板
20 處理列以通常運轉時之步驟處理基板步驟，同時可使其他
21 基板處理列以試運轉時之步驟處理基板。藉此，即使在試
22 運轉時，亦可抑制本裝置之稼動率降低。在進行試運轉之
23 處理單元的階層中，上述控制部最好使基板僅搬送至進行
24 該試運轉之處理單元。藉由使基板僅搬送至進行該試運轉
25 的處理單元，而可較佳地試驗、驗證、確認該處理單元對
26 基板所進行的處理品質。

01 (2) 本發明為一種處理基板的基板處理裝置，其包含以下元件
02 ；複數基板處理列，可將基板以大致水平方向搬送，同時
03 對基板進行複數種類之處理；及控制部，針對每個基板處
04 理列改變處理基板的步驟，可針對每個基板處理列而改變
05 對基板進行的處理步驟，上述複數基板處理列最好排列設
06 置於上下方向，上述控制部最好可使各基板處理列中之步
07 驟在各基板處理列間不同，亦可使各基板處理列中之步驟
08 在全部基板處理列相同。

09 (三) 系爭專利主要圖式如附圖一所示。

10 (四) 系爭專利申請專利範圍分析：

11 系爭專利之專利權人於本院審理中，於107年9月13日提出
12 申請專利範圍更正本（更正請求項2、3、5、6、8、10
13 、13、14、16、17、18，經被告審查核准，並於107年11月
14 1日公告（見本院卷三第459-465頁）。本件原告提出舉發
15 之請求項2至11、13至14、16至20，更正後之內容如下：

16 2. 一種基板處理裝置，用以處理基板，其包含以下元件：複
17 數個基板處理列，可以大致水平方向搬送基板並同時對基
18 板進行複數種類之處理；及控制部，針對每個基板處理列
19 而改變處理基板的步驟；於上下方向排列設置上述複數個
20 基板處理列；上述基板處理列分別具備有複數個處理單元
21 、及將基板搬送至此等處理單元的主搬送機構；上述控制
22 部在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同
23 時在其他基板處理列藉由改變處理基板的步驟以用來使處
24 理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運
25 轉時之步驟處理基板，其中，上述複數個處理單元的種類
26 ，在基板處理列之間為相同。

- 01 3. 一種基板處理裝置，用以處理基板，其包含以下元件：複
02 數個基板處理列，可以大致水平方向搬送基板並同時對基
03 板進行複數種類之處理；及控制部，針對每個基板處理列
04 而改變處理基板的步驟；於上下方向排列設置上述複數個
05 基板處理列；上述基板處理列分別具備有複數個處理單元
06 、及將基板搬送至此等處理單元的主搬送機構；上述控制
07 部在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同
08 時在其他基板處理列藉由改變處理基板的步驟以用來使處
09 理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運
10 轉時之步驟處理基板，其中，上述控制部可使各基板處理
11 列中之步驟在各基板處理列間不同，且可使各基板處理列
12 中之步驟在全部基板處理列間相同。
- 13 4. 如申請專利範圍第3項之基板處理裝置，其中，上述控制
14 部可使全部基板處理列中之步驟為用以在基板形成阻劑膜
15 、及用以對基板實施顯像的步驟。
- 16 5. 一種基板處理裝置，用以處理基板，其包含以下元件：複
17 數個基板處理列，可以大致水平方向搬送基板並同時對基
18 板進行複數種類之處理；及控制部，針對每個基板處理列
19 而改變處理基板的步驟；於上下方向排列設置上述複數個
20 基板處理列；上述基板處理列分別具備有複數個處理單元
21 、及將基板搬送至此等處理單元的主搬送機構；上述控制
22 部在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同
23 時在其他基板處理列藉由改變處理基板的步驟以用來使處
24 理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運
25 轉時之步驟處理基板，其中，上述基板處理裝置進一步具
26 備有輸入部，其輸入用以對每個基板處理列設定基板搬送

01 路徑之資訊；上述控制部係根據輸入至上述輸入部之資訊
02 ，改變各基板處理列的搬送路徑；輸入至上述輸入部之資
03 訊係特定進行試運轉之處理單元的資訊；上述控制部係根
04 據特定進行試運轉之處理單元的資訊，決定將基板僅搬送
05 至所特定之處理單元的搬送路徑。

06 6. 一種基板處理裝置，用以處理基板，其包含以下元件：複
07 數個基板處理列，可以大致水平方向搬送基板並同時對基
08 板進行複數種類之處理；及控制部，針對每個基板處理列
09 而改變處理基板的步驟；於上下方向排列設置上述複數個
10 基板處理列；上述基板處理列分別具備有複數個處理單元
11 、及將基板搬送至此等處理單元的主搬送機構；上述控制
12 部在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同
13 時在其他基板處理列藉由改變處理基板的步驟以用來使處
14 理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運
15 轉時之步驟處理基板，其中，上述控制部可使部分基板處
16 理列中之步驟為用以在基板形成阻劑膜、及用以對基板實
17 施顯像的步驟之全部，並同時使其他基板處理列中之步驟
18 為用以在基板形成阻劑膜、及用以對基板實施顯像的步驟
19 之一部分。

20 7. 如申請專利範圍第6項之基板處理裝置，其中，上述其他
21 基板處理列中之步驟為用以在基板形成阻劑膜的步驟、或
22 用以對基板實施顯像的步驟之任一者。

23 8. 一種基板處理裝置，用以處理基板，其包含以下元件：複
24 數個基板處理列，可以大致水平方向搬送基板並同時對基
25 板進行複數種類之處理；及控制部，針對每個基板處理列
26 而改變處理基板的步驟；於上下方向排列設置上述複數個

01 基板處理列；上述基板處理列分別具備有複數個處理單元
02 、及將基板搬送至此等處理單元的主搬送機構；上述控制
03 部在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同
04 時在其他基板處理列藉由改變處理基板的步驟以用來使處
05 理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運
06 轉時之步驟處理基板，其中，上述控制部可使部分基板處
07 理列進行由種類不同之複數處理所構成的步驟，並同時使
08 其他基板處理列進行由單一處理所構成的步驟。

09 9. 如申請專利範圍第8項之基板處理裝置，其中，上述由單
10 一處理構成的步驟為由對基板塗佈阻劑膜材料的阻劑膜材
11 料塗佈處理、對基板供給顯像液的顯像處理、及對基板進
12 行加熱或冷卻的熱處理中任一處理所構成的步驟。

13 10. 一種基板處理裝置，用以處理基板，其包含以下元件：複
14 數個基板處理列，可以大致水平方向搬送基板並同時對基
15 板進行複數種類之處理；及控制部，針對每個基板處理列
16 而改變處理基板的步驟；於上下方向排列設置上述複數個
17 基板處理列；上述基板處理列分別具備有複數個處理單元
18 、及將基板搬送至此等處理單元的主搬送機構；上述控制
19 部在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同
20 時在其他基板處理列藉由改變處理基板的步驟以用來使處
21 理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運
22 轉時之步驟處理基板，其中，上述控制部可使部分基板處
23 理列進行由種類不同之複數處理構成的第1步驟，並同時
24 使其他基板處理列進行由種類不同之複數處理構成且與第
25 1步驟不同的第2步驟。

26 11. 如申請專利範圍第10項之基板處理裝置，其中，上述第1

- 01 步驟及上述第2 步驟之至少一者，包含有對基板塗佈阻劑
02 膜材料的阻劑膜材料塗佈處理、對基板供給顯像液的顯像
03 處理、及對基板進行加熱或冷卻的熱處理中之至少一者。
- 04 13. 一種基板處理裝置，用以處理基板，其包含以下元件：橫
05 向排列的複數個處理區，具有設置在上下方向之每個階層
06 而用以處理基板的處理單元、和設置在各階層而用以對該
07 階層之處理單元搬送基板的主搬送機構；可在該處理區之
08 相同階層中相鄰接的主搬送機構彼此間交接基板，而在各
09 階層中對基板進行一連串處理；及控制部，控制各主搬送
10 機構，針對每個階層而改變基板相對於各階層處理單元的
11 搬送路徑；在進行試運轉之處理單元的階層中，上述控制
12 部藉由改變基板的搬送路徑使基板僅搬送至進行該試運轉
13 之處理單元，其中，上述控制部可在各階層中分別對基板
14 進行一連串處理之全部，或一連串處理之一部分。
- 15 14. 一種基板處理裝置，用以處理基板，其包含以下元件：橫
16 向排列的複數個處理區，具有設置在上下方向之每個階層
17 而用以處理基板的處理單元、和設置在各階層而用以對該
18 階層之處理單元搬送基板的主搬送機構；可在該處理區之
19 相同階層中相鄰接的主搬送機構彼此間交接基板，而在各
20 階層中對基板進行一連串處理；及控制部，控制各主搬送
21 機構，針對每個階層而改變基板相對於各階層處理單元的
22 搬送路徑；在進行試運轉之處理單元的階層中，上述控制
23 部藉由改變基板的搬送路徑使基板僅搬送至進行該試運轉
24 之處理單元，其中，試運轉時之步驟係為了使處理單元試
25 驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質而進行。
- 26 16. 一種基板處理裝置，用以處理基板，其包含以下元件：橫

01 向排列的複數個處理區，具有設置在上下方向之每個階層
02 而用以處理基板的處理單元、和設置在各階層而用以對該
03 階層之處理單元搬送基板的主搬送機構；可在該處理區之
04 相同階層中相鄰接的主搬送機構彼此間交接基板，而在各
05 階層中對基板進行一連串處理；及控制部，控制各主搬送
06 機構，針對每個階層而改變基板相對於各階層處理單元的
07 搬送路徑；在進行試運轉之處理單元的階層中，上述控制
08 部藉由改變基板的搬送路徑使基板僅搬送至進行該試運轉
09 之處理單元，具備有輸入用以針對每個階層設定基板搬送
10 路徑之資訊的輸入部，上述控制部根據輸入至上述輸入部
11 的資訊而改變各階層之搬送路徑，其中，輸入至上述輸入
12 部的資訊，為在各階層中對基板所進行的處理之種類與其
13 次序的相關資訊。

14 17. 一種基板處理裝置，用以處理基板，其包含以下元件：橫
15 向排列的複數個處理區，具有設置在上下方向之每個階層
16 而用以處理基板的處理單元、和設置在各階層而用以對該
17 階層之處理單元搬送基板的主搬送機構；可在該處理區之
18 相同階層中相鄰接的主搬送機構彼此間交接基板，而在各
19 階層中對基板進行一連串處理；及控制部，控制各主搬送
20 機構，針對每個階層而改變基板相對於各階層處理單元的
21 搬送路徑；在進行試運轉之處理單元的階層中，上述控制
22 部藉由改變基板的搬送路徑使基板僅搬送至進行該試運轉
23 之處理單元，具備有輸入用以針對每個階層設定基板搬送
24 路徑之資訊的輸入部，上述控制部根據輸入至上述輸入部
25 的資訊而改變各階層之搬送路徑，其中，輸入至上述輸入
26 部的資訊，為用以特定進行試運轉之處理單元的資訊；上

01 述控制部係根據特定進行試運轉之處理單元的資訊，決定
02 將基板僅搬送至所特定之處理單元的搬送路徑，其中，試
03 運轉時之步驟係為了使處理單元試驗、檢查或驗證對基板
04 所進行處理的品質而進行。

05 18. 一種基板處理裝置，用以處理基板，其包含以下元件：橫
06 向排列的複數個處理區，具有設置在上下方向之每個階層
07 而用以處理基板的處理單元、和設置在各階層而用以對該
08 階層之處理單元搬送基板的主搬送機構；可在該處理區之
09 相同階層中相鄰接的主搬送機構彼此間交接基板，而在各
10 階層中對基板進行一連串處理；及控制部，控制各主搬送
11 機構，針對每個階層而改變基板相對於各階層處理單元的
12 搬送路徑；在進行試運轉之處理單元的階層中，上述控制
13 部藉由改變基板的搬送路徑使基板僅搬送至進行該試運轉
14 之處理單元，其中，上述處理區包含有塗佈處理區與顯像
15 處理區，上述塗佈處理區具備有對基板塗佈處理液的塗佈
16 處理單元作為上述處理單元，上述顯像處理區具備有對基
17 板供給顯像液的顯像處理單元作為上述處理單元。

18 19. 如申請專利範圍第18項之基板處理裝置，其中，上述控制
19 部可對在上述塗佈處理區之全部階層，將所搬入的基板於
20 在上述塗佈處理單元進行處理後送出至該塗佈處理區之外
21 部，且可對在上述塗佈處理區之部分階層，將所搬入的基
22 板於在上述塗佈處理單元進行處理後送出至該塗佈處理區
23 之外部，並同時對在上述塗佈處理區之其他階層，將所搬
24 入的基板在未搬送至上述塗佈處理單元之情況下送出至該
25 塗佈處理區之外部。

26 20. 如申請專利範圍第18項之基板處理裝置，其中，上述控制

01 部可對在上述顯像處理區之全部階層，將所搬入的基板於
02 在上述顯像處理單元進行處理後送出至該顯像處理區之外
03 部，並且可對在上述顯像處理區之部分階層，將所搬入的
04 基板於在上述顯像處理單元進行處理後送出至該顯像處理
05 區之外部，並同時對在上述顯像處理區之其他階層，將所
06 搬入的基板在未搬送至上述顯像處理單元之情況下送出至
07 該顯像處理區之外部。

08 三、證據技術分析：

09 (一)原證4 至8 之公開日、原證16之公告日係早於系爭專利之優
10 先權日（2007年12月28日），均可為系爭專利相關之先前技
11 術。

12 (二)原證4（即舉發證據2）為2004年3月18日公開之日本第
13 0000-00000號「基板處理裝置」專利案（專利說明書及中
14 文節譯，見本院卷一第185-213頁）：

15 (1)原證4為一基板處理裝置之發明，如圖1、圖3所示，上
16 述第1、第3、第4處理單元9、11、12係例如主要由1
17 階部分與2階部分所構成之2階段結構。如圖3所示，第
18 1處理單元9之1階部分係配設有將用以防止來自基板W
19 上所形成之光阻膜的光線反射之下底用反射防止膜（
20 Bottom Ant-Reflection Coating）塗布形成於基板W之
21 BARC單元14、用以將基板W邊旋轉邊將光阻膜塗布形成於
22 基板W之旋轉塗布機（Spin Coater）（下稱「SC」）的
23 SC單元15。第1處理單元9之2階部分亦構成為與前述1
24 階相同。第1處理單元9之2階部分的上方位置係配設有
25 用以將基板W熱處理之熱處理部（下稱「HP-CP」）24、
26 用以將基板W冷卻處理之冷卻處理部（下稱「CP」、用以

01 不進行熱處理而將基板W 載置來收授基板之基板收授部（
02 下稱「Pass1」）。另外，此第1 處理單元9 係配設有用
03 以在各階之BARC單元14或SC單元15等與第2 處理單元10之
04 間收授基板，而可自由地存取於各階之SC用搬送機構17。
05 處理列13之內係從分配器2 側依序並列而配設有該等第1
06 處理單元9、第2 處理單元10、第3 處理單元11、第4 處
07 理單元12。各處理列13係相互獨立，可分別獨自地作動，
08 亦可個別地給予電源。上述各實施例中，雖係以2 系統之
09 處理列13將相同基板處理並聯來加以進行，但亦可是以一
10 邊的處理列13對基板W 進行第1 處理，以其他處理列13對
11 基板W 進行與第1 處理不同之第2 處理。

12 (2)原證4 主要圖式如附圖二所示。

13 (三)原證5（即舉發證據3）為2004年8月26日公開之日本第00
14 00-000000 號「成膜裝置」專利案（專利說明書及中文節譯
15，見本院卷一第214-224 頁、卷二第902頁）：

16 (1)原證5 揭露一種成膜裝置，係從基板搬送路徑分歧而設有
17 複數處理室，故在將基板朝一邊處理室搬送處理期間，可
18 進行另邊處理室相關之維修或條件變更，縱使係複數連續
19 地配置處理工序間之搬送路徑及處理室之大型系統，仍可
20 不停止整體之處理來實施維護等。又，藉由從搬送路徑分
21 歧而設置複數處理室，可不設置複數大型系統，縱使一個
22 系統仍能藉由併行處理來達到生產性的擴大。成膜裝置10
23 係從搬送路徑11將玻璃基板1 之搬送方向分為朝任一處理
24 室12a, 12b，故係於搬送路徑11內設有分配裝置13。分配
25 裝置13係由可旋轉之臂型機器人R 所構成，會從前方之處
26 理室或搬送路徑接收所送來之玻璃基板1，基於控制裝置

01 (未圖示)之指示進行將其玻璃基板1之搬送方向分開而
02 送出至處理室12a,12b之任一者的處理。

03 (2)原證5主要圖式如附圖三所示。

04 (四)原證6(即舉發證據4)為1994年1月14日公開之日本第6
05 -5689號「半導體基板處理系統」專利案(專利說明書及中
06 文節譯,見本院卷一第225-231頁):

07 (1)原證6揭露一種半導體基板處理系統,圖1係概略顯示本
08 實施例相關之半導體基板處理系統10構成之俯視圖。本實
09 施例之阻劑處理系統10係具備有晶圓收納容器11,17、洗
10 淨處理裝置12、阻劑塗布裝置13、烘烤處理裝置14,16、
11 顯像處理裝置15、搬送裝置18、控制裝置19及操作部20。
12 如圖4所示,關於複數處理工序(同圖中A至C)係藉由
13 操作部20輸入進行處理之半導體晶圓的片數、所使用處理
14 裝置之種類及其順序,再者,藉由輸入關於各處理裝置之
15 各處理的處理條件,便可以一次的輸入作業來進行關於複
16 數次處理工序之設定輸入,再者,可連續地進行該等處理
17 工序。

18 (2)原證6主要圖式如附圖四所示。

19 (五)原證7(即舉發證據5)為2005年4月14日公開之日本第
20 0000-000000號「基板處理裝置」專利案(專利說明書及中
21 文節譯,見本院卷一第32-245頁):原證7揭露一種基板處
22 理裝置,在對基板進行既定處理之基板處理裝置中,會在實
23 際運作前進行用以確認其動作之試驗性運轉(動作測試)。
24 其專利文獻1中,會以修正基板處理裝置所設定之基板處理
25 條件為目的,實際對基板進行塗布形成光阻、曝光處理及顯
26 影處理來作為動作測試。然後,測定作為結果所得之阻劑圖

01 案的形狀，並基於該測定結果來修正對剩下之基板的處理條
02 件。

03 (六)原證8 為2005年8 月16日公開之我國第200526494 號「基板
04 處理裝置之控制方法及基板處理裝置」專利案（專利說明書
05 見本院卷一第281-316 頁）：

06 (1)原證8 之發明目的在於在具有檢查部之塗布顯像處理裝置
07 中可縮短試運轉時所需的時間並降低成本且提高檢查部之
08 運轉率。本發明中，在塗布顯像處理裝置之控制程式中，
09 係設定成可獨立地執行處理流程與檢查流程，該處理流程
10 係將基板從匣盒站搬送至處理站，且在處理站及曝光裝置
11 中進行處理，然後使基板返回匣盒站，而前述檢查流程係
12 將基板從匣盒站搬送至檢查站，然後使基板返回匣盒站。
13 在塗布顯像處理裝置之試運轉時，可執行檢查流程與處理
14 流程，並可同時進行檢查站之檢查單元的評定作業與處理
15 站之處理單元的調整作業。當檢查站空著時，可從外部將
16 基板搬入匣盒站並進行檢查。

17 (2)原證8 主要圖式如附圖五所示。

18 (七)原證16 為2005年8 月16日公開之我國第200526494 號「基板
19 處理裝置之控制方法及基板處理裝置」專利案（專利說明書
20 及中文節譯，見本院卷二第918-934 頁）：

21 (1)原證16 揭露一種半導體晶圓處理機器之分配控制系統，含
22 有主控制模組和複數應用控制模組。各應用控制模組和主
23 控制模組可獨立自主操作。主控制模組調整應用控制模組
24 的操作，而應用控制模組管制由晶圓處理機器進行的許多
25 子程序。

26 (2)原證16 主要圖式如附圖六所示。

01 四、技術爭點分析：

02 (一) 系爭專利之「試運轉」用語的解釋：

03 (1) 系爭專利之「試運轉」用語應解釋為「以試驗、檢查、驗
04 證或確認處理單元對基板處理的品質或處理單元運作是否
05 正常為目的之運轉」。

06 1. 按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請
07 專利範圍時，並得審酌說明書及圖式，專利法第58條第
08 4 項定有明文。關於申請專利權範圍之解釋，原則上應
09 以系爭專利申請專利範圍中所記載之文字意義及該文字
10 在相關技術中通常總括的範圍，予以認定，蓋因申請專
11 利範圍一經公告，即具有對外公示之功能及效果，為使
12 公眾有一致之信賴，因此解釋申請專利範圍應以「客觀
13 合理方式」解釋其文字的客觀意義，非探求申請人之主
14 觀意思。解釋申請專利範圍既在探知申請人於申請當時
15 記載於申請專利範圍之客觀意義，應以該發明所屬技術
16 領域中具有通常知識者，就該文字於系爭專利申請時於
17 相關技術領域中所被認知或瞭解之範圍予以解釋，除非
18 申請人於說明書中賦予該文字特定之定義，否則應以該
19 發明領域中之通常知識者通常習慣之意義作為申請專利
20 範圍中之文字意義，並應以內部證據為優先適用，當內
21 部證據無法清楚顯示其意義時，始參酌外部證據解釋之
22 。

23 2. 系爭專利之「試運轉」用語的解釋，由系爭專利說明書
24 第17頁最末行至第18頁第3 行記載：「基板處理列Lu、
25 Ld中之步驟，在以基板處理為目的之下，分別為通常運
26 轉時之步驟。又，基板處理列Lu、Ld中之步驟，在以處

01 理品質之確認和試驗、或處理單元之試運轉等為目的之
02 下，則為試運轉時之步驟」，系爭專利說明書第18頁12
03 至14行記載「在圖2所示之情況下，基板處理列Lu、Ld
04 中各步驟在以試運轉為目的之下，亦為試運轉時之步驟
05 ，在以基板處理為目的之下，亦為通常時之步驟」，系
06 爭專利請求項2記載「控制部在部分基板處理列以通常
07 運轉時之步驟處理基板，並同時在其他基板處理列以用
08 來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品
09 質之試運轉時之步驟處理基板」，可知系爭專利之相同
10 之各步驟，係因不同之試運轉或基板處理目的，而被分
11 別認定為試運轉或通常運轉之步驟，簡言之，系爭專利
12 之「使處理單元試驗、驗證、確認對基板所進行處理的
13 品質」並非「試運轉」之步驟，而係為「試運轉」之目
14 的；系爭專利之「試運轉」係以試驗、檢查、驗證或確
15 認處理單元對基板處理的品質為目的之運轉，其中試驗
16 、檢查、驗證或確認處理單元對基板處理的品質，即相
17 當於試驗、檢查、驗證或確認處理單元運作是否正常。
18 因此，系爭專利之「試運轉」用語之文字意義，依其說
19 明書及申請專利範圍之內部證據即能清楚顯示其意義，
20 自然無須參酌外部證據。系爭專利之「試運轉」用語應
21 解釋為「以試驗、檢查、驗證或確認處理單元對基板處
22 理的品質或處理單元運作是否正常為目的之運轉」。

23 3. 參加人訴訟代理人於107年6月13日準備程序所提「系
24 爭專利—試運轉」簡報第16頁主張系爭專利之試運轉定
25 義為「以『通常運轉』以外的『其他基板處理列』，『
26 改變處理基板的步驟』，處理單元以用來試驗、檢查或

01 驗證對該基板所進行的處理的品質為目的地處理基板，
02 藉此抑制裝置之稼動率降低』」云云。惟查前述參加人
03 主張之內容，係為系爭專利說明書及申請專利範圍用以
04 說明系爭專利之「基板處理裝置」之整體技術內容、發
05 明目的及界定其專利權範圍，而非用以解釋系爭專利之
06 「試運轉」用語之文字意義，參加人之主張尚不可採。

07 4. 參加人107 年12月27日行政訴訟參加人答辯（七）狀雖
08 主張，參加人於107 年9 月13日向被告申請更正系爭專
09 利請求項2 、3 、5 、6 、8 、10、13、14、16至18，
10 經被告核准並於107 年11月1 日公告，故請求本院依「
11 更正」公告內容，重新解釋「試運轉」云云。

12 按「請求項及說明書中之相同用語，應為一致或相同
13 含意之解釋」、「同一專利案之不同請求項中之相同
14 用語，應為相同含意之解釋」（參專利侵權判斷要點
15 第一編第二章第2.6.1.1 (1)、(3)點），換言之，系爭
16 專利之「試運轉」一詞，於系爭專利說明書及各請求
17 項中，應為一致之解釋，並不會因為各請求項所界定
18 之技術特徵不同，而有不同之解釋。

19 本院就系爭專利之「試運轉」用語，經審酌系爭專利
20 申請專利範圍及說明書所載內容，認為應解釋為「以
21 試驗、檢查、驗證或確認處理單元對基板處理的品質
22 或處理單元運作是否正常為目的之運轉」。

23 查，系爭專利107 年9 月13日之更正內容（參證12專
24 利更正申請書之附件）係將原公告系爭專利請求項2
25 、3 、5 、6 、8 、10之「上述控制部在部分基板處
26 理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他基

01 板處理列以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板
02 所進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基板」更正
03 為「上述控制部在部分基板處理列以通常運轉時之步
04 驟處理基板，並同時在其他基板處理列『藉由改變處
05 理基板的步驟』以用來使處理單元試驗、檢查或驗證
06 對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基板
07 」。並將系爭專利請求項13、14、16至18之附屬項記
08 載形式更正為獨立項記載形式，並將其原公告系爭專
09 利請求項13、14、16至18實質記載之「上述控制部使
10 基板僅搬送至進行該試運轉之處理單元」更正為「上
11 述控制部『藉由改變基板的搬送路徑』使基板僅搬送
12 至進行該試運轉之處理單元」。簡言之，系爭專利
13 107年9月13日之更正內容，係就系爭專利請求項2
14 、3、5、6、8、10、13、14、16至18分別進一步
15 界定「控制部……藉由改變處理基板的步驟」、「控
16 制部藉由改變基板的搬送路徑」之技術特徵，該更正
17 內容僅係就「控制部」為進一步之界定，而不會影響
18 或改變前述系爭專利「試運轉」於系爭專利說明書及
19 各該請求項中，所為之一致解釋，是以本院認為並無
20 重新解釋系爭專利之「試運轉」用語之必要。

21 (二)原證4、8之組合、原證4、16之組合、原證4、8、16之
22 組合、原證4至6之組合、原證4至7之組合是否足以證明
23 系爭專利請求項2至4、6至11不具進步性？

24 (1)原證4、8之組合、原證4、16之組合、原證4、8、16
25 之組合不足以證明系爭專利請求項2不具進步性，原證4
26 至6之組合、原證4至7之組合足以證明系爭專利請求項

01 2 不具進步性：

02 1. 原證4、8 之組合、原證4、16 之組合、原證4、8、

03 16 之組合不足以證明系爭專利請求項2 不具進步性：

04 系爭專利請求項2 之內容，已如前述。

05 系爭專利請求項2 與原證4 比較，原證4 圖1 至3 揭

06 露一基板處理裝置，具有2 個處理列13，可大致呈水

07 平XY 方向搬送基板並同時對基板進行BARC、SC、SD、

08 HP、CP 等處理及搬送機構17、20 及22，且2 個處理列

09 13 具有相同之複數個處理單元，該複數個處理單元的

10 種類（如BARC、SC、SD、HP、CP 等處理單元種類），

11 在2 個處理列13 間為相同，原證4 圖1 至3 已揭露系

12 爭專利之「基板處理裝置」、「複數個基板處理列」

13、「複數個處理單元」、「主搬送機構」、「複數個

14 處理單元的種類，在基板處理列之間為相同」等技術

15 特徵。又原證4 第〔0134〕段揭露「一邊之處理列13

16 對基板W 進行第1 處理，以其他處理列13 對基板W 進

17 行與第1 處理不同之第2 處理」。原證4 第〔0134〕

18 段實質揭露一「控制部」以控制複數個處理列13 以同

19 時進行第1 處理及第2 處理。原證4 圖1 至3、第〔

20 0040〕段揭露2 個處理列13 係併設於y 方向，各個處

21 理列13 係將其「處理單元以上、下不同階層方式設置

22」，簡單修飾原證4 之處理單元排列方式為不同處理

23 列之處理單元，分別設置於上、下不同階層（如一處

24 理列之處理單元設置在上階層、另一處理列之處理單

25 元設置在下階層），即能輕易完成系爭專利之「於上

26 下方向排列設置上述複數個基板處理列」技術特徵。

01 惟查，原證4 第〔0134〕段僅有揭露對基板W 進行第
02 1 處理、第2 處理，原證4 並未揭露進行該第1 處理
03 、第2 處理之目的，更遑論揭露進行該第1 處理、第
04 2 處理係為以試驗、檢查、驗證或確認處理單元對基
05 板處理的品質或處理單元運作是否正常為目的之運轉
06 ，是以原證4 並未提及任何「試運轉」之技術內容，
07 故未揭露系爭專利之「控制部在部分基板處理列以通
08 常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他基板處理列
09 藉由改變處理基板的步驟以用來使處理單元試驗、檢
10 查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟
11 處理基板」技術特徵。

12 系爭專利請求項2 與原證8 比較，原證8 揭露一基板
13 處理裝置及其控制方法，原證8 摘要揭露一具有檢查
14 部之塗布顯像處理裝置於試運轉時，可執行檢查流程
15 與處理流程，並可同時進行檢查站之檢查單元的評定
16 作業與處理站之處理單元的調整作業，原證8 第8 頁
17 第1 至8 行揭露「由於獨立地執行基板處理流程與檢
18 查流程，因此，在基板處理裝置之試運轉時，可執行
19 基板檢查流程，並可將搬入「搬入搬出部」之例如評
20 定用基板直接搬送至檢查部進行檢查」、「可同時進
21 行基板之檢查流程及處理流程」，惟原證8 並未揭露
22 複數個基板處理列，故未揭露系爭專利之「於上下方
23 向排列設置上述複數個基板處理列」及「控制部在部
24 分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時
25 在其他基板處理列藉由改變處理基板的步驟以用來使
26 處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質

01 之試運轉時之步驟處理基板」技術特徵。

02 原告106年9月25日行政訴訟準備(一)狀第5至6

03 、8至9頁主張：原證8已揭露系爭專利之「控制部

04 在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並

05 同時在其他基板處理列以用來使處理單元試驗、檢查

06 或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟處

07 理基板」技術特徵云云。惟查，由前述原證8揭露之

08 內容可知，原證8係揭露一具有檢查部之塗布顯像處

09 理裝置於試運轉時，可執行檢查流程與處理流程，故

10 可同時進行檢查站之檢查單元的評定作業與處理站之

11 處理單元的調整作業，換言之，原證8揭露在進行試

12 運轉時，同時進行之基板處理流程與檢查流程均屬「

13 試運轉時之步驟」，原證8未揭露對不同基板分別以

14 「通常運轉時之步驟」及「試運轉時之步驟」同時進

15 行處理之相關技術內容或教示、建議，故原證8未揭

16 露系爭專利之「控制部在部分基板處理列以通常運轉

17 時之步驟處理基板，並同時在其他基板處理列藉由改

18 變處理基板的步驟以用來使處理單元試驗、檢查或驗

19 證對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基

20 板」技術特徵，原告之主張，尚不可採。

21 系爭專利請求項2與原證16比較，原證16摘要揭露一

22 種半導體晶圓處理機器之分配控制系統、原證16說明

23 書第1欄第34至41行揭露處理系統的安裝、測試、故

24 障排除、維護等成本，亦直接關係到控制系統的複雜

25 性，原證16說明書第2欄第27至29行揭露分配控制系

26 統另一優點是，各子系統可單獨測試和診斷，而不需

01 整個處理系統進行動作，惟原證¹⁶並未揭露複數個基
02 板處理列，故未揭露系爭專利之「於上下方向排列設
03 置上述複數個基板處理列」及「控制部在部分基板處
04 理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他基
05 板處理列藉由改變處理基板的步驟以用來使處理單元
06 試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉
07 時之步驟處理基板」技術特徵。原證¹⁶係揭露分配控
08 制系統之各子系統可單獨測試和診斷，而不需整個處
09 理系統進行動作，惟未揭露對不同基板分別以「通常
10 運轉時之步驟」及「試運轉時之步驟」同時進行處理
11 之相關技術內容或教示、建議。

12 原告¹⁰⁷年4月27日行政訴訟準備(三)狀第6至7
13 頁主張：原證¹⁶所揭露之用於半導體晶圓處理之控制
14 系統，不僅能夠針對個別基板處理進行調整和控制不
15 同處理方略的應用，更可以平行方式控制和調整各種
16 副系統使各子系統可「同時進行」相同或不同之通常
17 或特殊處理，其中各子系統同時更可單獨進行測試、
18 診斷，以減少停工時間並增加晶圓產量。此外，原證
19 ¹⁶所揭露對半導體處理系統之「單獨測試和診斷」、
20 「處理系統的安裝、試驗、故障排除、維護」等，即
21 相當於系爭專利請求項「用來使處理單元試驗、檢查
22 或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉」之處理步
23 驟。因此，原證¹⁶已明確揭露及教示系爭專利請求項
24 2之技術特徵⁵「上述控制部在部分基板處理列以通
25 常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他基板處理列
26 以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處

01 理的品質之試運轉時之步驟處理基板」之技術內容云
02 云。惟查，原證16說明書第1欄第34至41行揭露處理
03 系統的安裝、測試（testing）、故障排除、維護等
04 成本，亦直接關係到控制系統的複雜性，原證16說明
05 書第2欄第27至29行揭露分配控制系統另一優點是，
06 各子系統可單獨測試（tested）和診斷，原證16之測
07 試和診斷雖相當於系爭專利之「試運轉」技術特徵，
08 惟原證16係揭露各子系統可單獨測試（tested）和診
09 斷，而不需整個處理系統進行動作，原證16未揭露或
10 教示系爭專利請求項2之技術特徵5「上述控制部在
11 部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同
12 時在其他基板處理列藉由改變處理基板的步驟以用來
13 使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品
14 質之試運轉時之步驟處理基板」之技術內容，原告之
15 主張尚不可採。

16 綜上，原證4第〔0134〕段及圖1至3已揭露系爭專
17 利之「基板處理裝置」、「複數個基板處理列」、「
18 複數個處理單元」、「主搬送機構」、「複數個處理
19 單元的種類，在基板處理列之間為相同」、「控制部
20 」等技術特徵。可簡單修飾原證4圖1至3、第〔
21 0040〕段揭露之處理列13之設置方向，而輕易完成系
22 爭專利之「於上下方向排列設置上述複數個基板處理
23 列」技術特徵。惟原證4、8、16未揭露對不同基板
24 分別以「通常運轉時之步驟」及「試運轉時之步驟」
25 同時進行處理之相關技術內容或教示、建議，所屬技
26 術領域中具有通常知識者依據原證4、8、16等先前

01 技術，無法藉由簡單的轉用、置換、修飾等手段而能
02 輕易完成系爭專利之「控制部在部分基板處理列以通
03 常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他基板處理列
04 藉由改變處理基板的步驟以用來使處理單元試驗、檢
05 查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟
06 處理基板」技術特徵。原證4、8之組合、原證4、
07 16之組合、原證4、8、16之組合不足以證明系爭專
08 利請求項2不具進步性。

09 (2) 原證4至6之組合、原證4至7之組合足以證明系爭專利
10 請求項2不具進步性：

11 1. 系爭專利請求項2與原證5比較，原證5第〔0046〕揭
12 露可在一邊的處理室與另邊的處理室以不同的條件來併
13 行實施成膜，能不停止生產而機動性且效率良好地進行
14 新製程的條件試出（瀟件出），原證5第〔0015〕段
15 揭露「在基板朝一邊處理室搬送處理期間，可進行另邊
16 處理室相關之維修或條件變更」，是以原證5揭露在進
17 行新製程的條件試出時，一邊處理室進行通常的成膜工
18 序以進行生產，另一邊處理室則會進行新製程的「條件
19 試出」；簡言之，原證5第〔0046〕段揭露在不同處理
20 室併行進行的通常的成膜工序及條件試出，原證5之「
21 條件試出」係具有以試驗、檢查、驗證或確認處理室對
22 基板處理品質為目的之處理程序，原證5之「條件試出
23 」即相當於系爭專利之「試運轉」技術特徵。

24 2. 被告107年1月4日行政訴訟答辯書第4頁第17至26行
25 主張：原證5第〔0019〕、〔0029〕、〔0046〕段揭露
26 一單一製程之成膜裝置，比對為系爭專利之可執行複數

01 種類製程處理之複數個基板處理列並不恰當，原證5 未
02 揭露系爭專利之「試運轉」云云。惟查原證5 第〔0015
03 〕段揭露在基板朝一邊處理室搬送處理期間，可進行另
04 邊處理室相關之維修或條件變更，原證5 第〔0046〕段
05 在不同處理室併行進行的通常的成膜工序及條件試出；
06 原證5 之條件試出即係對未達通常運轉之生產條件之處
07 理室，進行基板之試驗性處理。雖原證5 之單一製程之
08 成膜裝置在硬體結構上有別於系爭專利係為可執行複數
09 種類製程處理之複數個基板處理列，然就通常運轉前所
10 為之試驗性處理觀之，二者技術思想實質上並無差異，
11 原證5 之「條件試出」係具有以試驗、檢查、驗證或確
12 認處理室對基板處理品質為目的之處理程序，是以原證
13 5 之「條件試出」即相當於系爭專利之「試運轉」技術
14 特徵，被告之主張，尚不可採。

- 15 3. 系爭專利請求項2 與原證6 比較，原證6 第〔0013〕段
16 揭露的「條件試出」為處理裝置對半導體晶圓一邊改變
17 處理條件，一邊試驗性的加以處理，是以原證6 之「條
18 件試出」係具有以試驗、檢查、驗證或確認處理裝置對
19 半導體晶圓處理品質為目的之試驗性處理，即相當於系
20 爭專利之「試運轉」技術特徵，原證6 第〔0024〕段及
21 圖1 揭露半導體基板處理系統10，其操作部20 連接控制
22 裝置19，具有晶圓收納容器11、17、洗淨處理裝置12、
23 阻劑塗布裝置13，烘烤處理裝置14、16、顯像處理裝置
24 15、搬送裝置18，原證6 第〔0034〕段及圖4 揭露「操
25 作部20 輸入進行處理之導體晶圓之片數、所使用處理裝
26 置之種類及順序，再者藉由輸入關於各處理裝置之各處

01 理條件，便可以一次的輸入作業來進行關於複數次處理
02 工序的設定輸入，再者，可連續地進行該等處理工序」
03 ，由前述原證6 之內容可知，操作部20可輸入設定所使
04 用處理裝置之種類及順序，使控制裝置19可改變基板處
05 理列之處理基板的步驟，即相當於系爭專利之「控制部
06 ，針對基板處理列而改變處理基板的步驟」技術特徵。

07 4. 系爭專利請求項2 與原證7 比較，原證7 第〔0002〕段
08 揭露「在對基板進行既定處理之基板處理裝置中，會在
09 實際運作前進行用以確認其動作之試驗性運轉（動作測
10 試），例如下述專利文獻1 中，會以修正基板處理裝置
11 所設定之基板處理條件為目的，實際對基板進行塗布形
12 成光阻，曝光處理及顯影處理來作為動作測試」，原證
13 7 之「試驗性運轉」具有以試驗、檢查、驗證或確認基
14 板處理裝置對基板處理的品質為目的之運轉，因此原證
15 7 第〔0002〕段揭露之「試驗性運轉」，即相當於系爭
16 專利之「試運轉」技術特徵。

17 5. 綜上，原證4 第〔0134〕段及圖1 至3 已揭露系爭專利
18 之「基板處理裝置」、「複數個基板處理列」、「複數
19 個處理單元」、「主搬送機構」、「複數個處理單元的
20 種類，在基板處理列之間為相同」、「控制部」等技術
21 特徵。系爭專利請求項2 與原證4 之差異為，原證4 揭
22 露之基板處理裝置中係具有2 個水平方式併列設置之處
23 理列13，原證4 的2 個處理列13並非以一處理列13在上
24 ，另一處理列13在下之上下方向排列設置，原證4 未揭
25 露系爭專利之「於上下方向排列設置上述複數個基板處
26 理列」，原證4 雖實質揭露「控制部」，然原證4 並未

01 揭露該控制部可以針對2 個處理列¹³改變處理基板的步
02 驟，原證⁴ 未揭露系爭專利之「控制部，針對每個基板
03 處理列而改變處理基板的步驟」、「在部分基板處理列
04 以通常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他基板處理
05 列藉由改變處理基板的步驟以用來使處理單元試驗、檢
06 查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟處
07 理基板」技術特徵。惟系爭專利所屬技術領域中具有通
08 常知識者由原證⁴ 圖1、3 (a) 揭露之基板處理裝置
09 中具有2 個處理列¹³，各個處理列¹³之「處理單元以上
10 下不同階層方式設置」，簡單修飾原證⁴ 之處理單元
11 排列方式為不同處理列之處理單元，分別設置於上、下
12 不同階層（如一處理列之處理單元設置在上階層、另一
13 處理列之處理單元設置在下階層），並無困難，即能輕
14 易完成系爭專利之「於上下方向排列設置上述複數個基
15 板處理列」技術特徵，並依據前述原證⁶ 第〔0013〕、
16 〔0024〕、〔0034〕段揭露相當於系爭專利之「試運轉
17 」、「控制部，對基板處理列而改變處理基板的步驟」
18 之內容，原證⁵ 第〔0046〕段揭露在不同處理室併行進
19 行的通常的成膜工序（相當於系爭專利之「通常運轉」
20 ）及條件試出（相當於系爭專利之「試運轉」），簡單
21 修飾原證⁴ 第〔0134〕段所實質揭露之「控制部」控制
22 各處理列以進行之第1 處理及第2 處理，使原證⁴ 之第
23 1 處理及第2 處理，其中之一者進行「通常運轉」而另
24 一者可改變處理步驟以進行「試運轉」，即能輕易完成
25 系爭專利之「控制部，針對每個基板處理列而改變處理
26 基板的步驟」、「在部分基板處理列以通常運轉時之步

01 驟處理基板，並同時在其他基板處理列藉由改變處理基
02 板的步驟以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所
03 進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基板」技術特徵
04 。

05 6. 原證4 至7 與系爭專利均為基板處理裝置之相同技術領
06 域；原證4 摘要揭露以2 個併列處理列以解決一處理列
07 故障之問題，原證5 第〔0015〕段揭露在基板朝一邊處
08 理室般送處理期間，可進行另邊處理室相關之維修或條
09 件變更，原證6 第〔0013〕段揭露的條件試出為將半導
10 晶圓一邊改變處理條件，一邊試驗性的加以處理，原證
11 7 第〔0002〕段揭露在對基板進行既定處理之基板處理
12 裝置中，會在實際運作前進行用以確認其動作之試驗性
13 運轉（動作測試），原證4 至7 與系爭專利均為解決基
14 板處理裝置維修或條件變更、試運轉時之問題，具有所
15 欲解決問題之共通性；原證4 至7 與系爭專利均係基板
16 處理裝置對基板進行成膜、曝光、顯像之步驟，具有功
17 能或作用上的共通性；原證4 至7 具有明顯之結合動機
18 。

19 系爭專利請求項2 為所屬技術領域中具有通常知識者
20 依原證4 至6 之內容所能輕易完成，是以原證4 至6 之
21 組合、原證4 至7 之組合足以證明系爭專利請求項2 不
22 具進步性。

23 7. 參加人於108 年1 月23 日準備程序主張：如何將原證5
24 原證6 控制器、原證16 控制器，結合到原證4 控制器，
25 這些原告都未說明。系爭專利的發明相對先前技術，至
26 少包含上下排列的基板處理列，以及同時在不同基板處
理列分別進行通常運轉及試運轉，藉由這些技術特徵可

01 以解決技術問題、效果都是從這些引證無法預期，系爭
02 專利應具備進步性云云。惟查，由前述系爭專利請求項
03 2 與原證4 比較之理由可知，原證4 已揭露系爭專利請
04 求項2 所界定之大部分技術特徵，至於系爭專利請求項
05 2 與原證4 之差異，關於原證4 之「複數個基板處理列
06 係以水平方式併列設置，而系爭專利請求項2 則界定
07 於上下方向排列設置上述複數個基板處理列」部分
08 由原證4 圖1、3 (a) 揭露之基板處理裝置中具有
09 2 個處理列¹³，各個處理列¹³之「處理單元以上、下不
10 同階層方式設置」，簡單修飾原證4 之處理單元排列方
11 式為不同處理列之處理單元，分別設置於上、下不同階
12 層（如一處理列之處理單元設置在上階層、另一處理列
13 之處理單元設置在下階層），並無困難，即能輕易完成
14 系爭專利請求項2 之「於上下方向排列設置上述複數個
15 基板處理列」技術特徵。關於系爭專利請求項2 之控制
16 部以「通常運轉」、「試運轉」之步驟處理基板部分，
17 查系爭專利請求項2 與原證4 之控制部，不論其處理單
18 元之運轉目的為何，就「將基板依序搬送到各該處理單
19 元進行處理」之控制功能而言，並無不同。原證5 為具
20 有2 個進行單一成膜處理的處理室的「真空成膜裝置」
21 原證6 至8 僅為單一產線的基板處理裝置，原證16 僅
22 為CMP（化學機械研磨）的單一產線，換言之，原證5
23 原證6 至8 原證16 之控制部與原證4 之可以控制二
24 個處理列之控制部在功能上，自然有所差異，但就「將
25 基板依序搬送到各該處理單元進行處理」之控制功能而
26 言，其本質上並無不同。如由原證5 第〔0046〕段揭露

01 在不同處理室併行進行的通常的成膜工序（相當於系爭
02 專利之「通常運轉」）及條件試出（相當於系爭專利之
03 「試運轉」）可知，原證5 已揭露控制部可控制搬送機
04 構（原證5 圖5 之旋臂型機器人R ），將不同基板分別
05 搬送到不同處理室以併行通常運轉目的之運轉及試運轉
06 目的之運轉的技術內容。由原證6 第〔0013〕段揭露的
07 「條件試出」即相當於系爭專利之「試運轉」技術特徵
08 ，原證6 第〔0034〕段及圖4 揭露「操作部20 輸入進行
09 處理之導體晶圓之片數、所使用處理裝置之種類及順序
10 ，再者藉由輸入關於各處理裝置之各處理條件，便可以
11 一次的輸入作業來進行關於複數次處理工序的設定輸入
12 ，再者，可連續地進行該等處理工序」可知，原證6 已
13 揭露控制部可控制搬送機（原證6 圖1 之搬送裝置18）
14 ，經由設定而改變搬送基板到各處理裝置的種類及搬送
15 順序以進行試運轉目的之運轉的技術內容。原證16 摘要
16 揭露一種半導體晶圓處理機器之分配控制系統，原證16
17 說明書第2 欄第27 至29 行揭露分配控制系統各子系統可
18 單獨測試（tested）和診斷（即相當於系爭專利之「試
19 運轉」技術特徵）可知，原證16 已揭露控制部可控制子
20 系統進行試運轉目的之運轉的技術內容。系爭專利所屬
21 技術領域中具有通常知識者，依據前述原證5 、6 、16
22 揭露之控制部技術內容，簡單修飾原證4 之控制部控制
23 搬送機構17、20 及22 搬送基板W 到各處理單元進行之第
24 1、2 處理，使得該各處理單元的種類及搬送基板W 到
25 該各處理單元的搬送順序係可經由設定而改變（即相當
26 於控制部可改變處理基板之步驟），簡單修飾原證4 之

01 控制部控制搬送機構17、20及22搬送基板W所進行之第
02 1、2處理之「處理目的」，使得其中一處理係為通常
03 運轉目的之運轉，而另一處理則為試運轉目的之運轉，
04 其本質上並無不相容之情事，且其技術上亦無困難，原
05 證4至6之組合、原證4至7之組合足以證明系爭專利
06 請求項2不具進步性，已如前述，參加人之主張尚不可
07 採。

08 8. 參加人107年7月31日行政訴訟參加人答辯（五）狀9
09 頁第7至12行及第15頁第4至8行、第22頁第3至9頁
10 主張：從「單一處理列」要實現具備「複數處理列」基
11 板處理裝置的同時，還必須防止「佔地面積」增大的問
12 題、抑制基板處理裝置的高度，以及搬送裝置在空間中
13 移動時所產生「顆粒（particle，灰塵）污染基板」的
14 問題，具有相當的「技術障礙」，系爭專利「複數個基
15 板處理列」的基板處理裝置，是通過「在上部搬送空間
16 和下部搬送空間之間藉由氣流吹出與排出單元的特定結
17 構，控制上下基板處理列搬送空間的氣流，以使各搬送
18 空間維持在清淨狀態」的方式加以實現，原告援引原證
19 5至原證8及原證16該「單一流程」或「單一產線」的
20 技術內容，考量到系爭專利提出當時的時空背景及技術
21 難度，究竟如何克服前述從「單一處理列」實現具備「
22 複數處理列」基板處理裝置的「技術障礙」？就此，原
23 告必須承擔「舉證責任」，提供證據充分支持其主張云
24 云。惟查，原證4至8、16係為系爭專利之相關先前技
25 術，雖原證5至8、16並未揭露「複數處理列」之技術
26 內容，然原證4圖1、3（a）已揭露「基板處理裝置

01 中具有2 個處理列¹³，各個處理列¹³係將其處理單元以
02 上下方向階層設置」等內容。因此，由「單一處理列」
03 實現「複數處理列」，已為系爭專利所屬技術領域之先
04 前技術，參加人無視於系爭專利之「複數處理列」已為
05 原證⁴ 所明確揭露之事實，而主張「單一處理列」要實
06 現具備「複數處理列」，具有相當的「技術障礙」云云
07 ，尚非可採。且參加人主張之「在上部搬送空間和下部
08 搬送空間之間藉由氣流吹出與排出單元的特定結構，控
09 制上下基板處理列搬送空間的氣流，以使各搬送空間維
10 持在清淨狀態」之技術內容，並未界定於系爭專利請求
11 項中，自非據以判斷系爭專利是否具有進步性之基礎，
12 參加人主張，不足採信。

13 9. 被告¹⁰⁷ 年1 月4 日行政訴訟答辯書第5 頁第7 至16行
14 主張：原證⁵ 所記載之控制裝置與原證⁴ 不相容，原證
15 ⁶ 的半導體基板處理系統¹⁰ 僅包含單一產線，非如系爭
16 專利之複數條處理列，原證⁴ 至⁶ 皆未揭露系爭專利之
17 「在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並
18 同時在其他基板處理列以用來使處理單元試驗、檢查或
19 驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基
20 板」云云。惟查，原證⁴ 至⁶ 雖未單獨揭露系爭專利之
21 「在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並
22 同時在其他基板處理列藉由改變處理基板的步驟以用來
23 使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質
24 之試運轉時之步驟處理基板」，然原證⁴ 至⁶ 均為基板
25 處理裝置之發明，雖原證⁵ 之單一製程之成膜裝置在硬
26 體結構上有別於原證⁴ 、⁶ 之可執行複數種類製程處理

01 之基板處理列，然就通常運轉前所為之試驗處理、改變
02 調整處理條件觀之，原證5 第〔0046〕段所揭露之條件
03 試出（相當於系爭專利之「試運轉」）與原證4、6 進
04 行基板處理並無不相容之情形，系爭專利所屬技術領域
05 中具有通常知識者依據原證5 第〔0046〕段揭露不同處
06 理室併行進行的通常的成膜工序（相當於系爭專利之「
07 通常運轉」）及條件試出（相當於系爭專利之「試運轉
08 ）」併同前述原證6 第〔0013〕、〔0024〕、〔0034〕
09 段揭露相當於系爭專利之「試運轉」、「控制部，對基
10 板處理列而改變處理基板的步驟」之內容，簡單修飾原
11 證4 第〔0134〕段揭露處理列之第1 處理及第2 處理，
12 使原證4 之第1 處理及第2 處理，其中之一者進行「通
13 常運轉」而另一者可改變處理步驟以進行「試運轉」，
14 即可輕易完成系爭專利之「在部分基板處理列以通常運
15 轉時之步驟處理基板，並同時在其他基板處理列藉由改
16 變處理基板的步驟以用來使處理單元試驗、檢查或驗證
17 對基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基板」
18 技術特徵，被告之主張尚不可採。

19 10. 參加人107 年4 月30日行政訴訟參加人答辯（二）狀第
20 2 至5 頁主張：「原證5 」屬於「半導體三段製程」中
21 的「薄膜成膜製程」，而「原證4 」屬於「半導體三段
22 製程」中的「微影製程」，二者分屬不同的「半導體製
23 程」，「原證5 」的處理室12a、12b 的處理乃為規定
24 真空度下才能進行成膜的蒸鍍處理，「原證4 」的塗佈
25 顯影裝置的塗佈與顯影處理均涉及處理液的處理，對基
26 板的處理環境全然不同，二者根本無法結合云云。惟查

01 ，原證4 與原證5 均屬半導體製程，具有技術領域之關
02 連性，原證4 之利用塗佈顯影裝置搭配曝光機進行光阻
03 圖案化製程與原證5 之利用真空腔室進行沈積或蒸鍍薄
04 膜雖有不同，但其同屬半導體三段製程，系爭專利所屬
05 技術領域中具有通常知識者依據原證5 第〔0046〕段揭
06 露在不同處理室併行進行的通常的成膜工序（相當於系
07 爭專利之「通常運轉」）及條件試出（相當於系爭專利
08 之「試運轉」），簡單修飾原證4 第〔0134〕段所實質
09 揭露之「控制部」控制各處理列以進行之第1 處理及第
10 2 處理，使原證4 之第1 處理及第2 處理，其中之一者
11 進行「通常運轉」而另一者進行「試運轉」，並無困難
12 ，是以原證4 與原證5 當然可以結合，參加人之主張，
13 尚不可採。

14 11. 參加人107 年4 月30 日行政訴訟答辯（二）狀第3 至4
15 頁、107 年7 月4 日行政訴訟陳報狀第1 至2 頁主張：
16 「原證5 」關於「瀨件出 」一詞，實應譯為「條件引
17 出」為宜，系爭專利的「試運轉」與「原證5 」的「條
18 件引出」（瀨件出 ），二者在技術含義上全然不同云
19 云。惟經審酌原證5 第〔0046〕段揭露在不同處理室併
20 行進行的通常的成膜工序及新製程「瀨件出 」，原證
21 6 第〔0013〕段揭露將1 片片或各2 至3 片之半導體晶
22 圓一邊改變處理條件，一邊試驗性的加以處理（以下將
23 此處理稱作「瀨件出 」），由前述原證5 、6 揭露之
24 內容可知，「瀨件出 」係可用於半導體晶圓欲進新製
25 程時，對半導體晶圓一邊改變處理條件，一邊試驗性的
26 加以處理，以找出適當的處理條件，以達到新製程要求

01 之品質之處理步驟，故為忠實表現「瀕件出」在原證
02 5、6中之真實意義，原證5第〔0046〕段及原證6第
03 〔0013〕段記載之「條件出」應譯為「條件試出」，
04 始可真實表達其意義，方屬合理妥適。雖原證5之單一
05 製程之成膜裝置在硬體結構上有別於系爭專利係為可執
06 行複數種類製程處理之複數個基板處理列，然就通常運
07 轉前所為之試驗性處理而言，原證5之「條件試出」與
08 系爭專利之「試運轉」並無實質差異，亦即，原證5之
09 「條件試出」係具有以試驗、檢查、驗證或確認處理品
10 質為目的之新製程試驗處理程序，原證5之「條件試出
11 」即相當於系爭專利之「試運轉」技術特徵，參加人之
12 主張，尚不可採。

13 12. 參加人107年4月30日行政訴訟參加人答辯（二）狀第
14 5至6頁主張：「原證4」處理列13是包含「複數種類
15 的處理單元」，而「原證5」的處理室12a、12b則為
16 「單一的處理單元」，二者在處理單元的核心構成上是
17 不同的，並以「假想例」說明系爭專利所屬技術領域的
18 通常知識者難以組合「原證4」與「原證5」云云。惟
19 查，原證4與原證5均屬半導體製程，具有技術領域之
20 關連性，原證4處理列13是包含「複數種類的處理單元
21 」，而原證5的處理室12a、12b則為「單一的處理單
22 元」，二者雖有不同，然系爭專利所屬技術領域中具有
23 通常知識者依據原證5第〔0046〕段揭露在不同處理室
24 併行進行的通常的成膜工序（相當於系爭專利之「通常
25 運轉」）及條件試出（相當於系爭專利之「試運轉」）
26 之技術思想，簡單修飾原證4第〔0134〕段所實質揭露

01 之「控制部」控制各處理列以進行之第1 處理及第2 處
02 理，使原證4 之第1 處理及第2 處理，其中之一者進行
03 「通常運轉」而另一者進行「試運轉」，即能輕易完成
04 系爭專利之「在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處
05 理基板，並同時在其他基板處理列以用來使處理單元試
06 驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時之
07 步驟處理基板」之技術特徵，是以原證4 與原證5 當然
08 可以結合而能完成前述系爭專利之技術特徵，且參加人
09 所舉原證4 與原證5 結合之「假想例」之內容與前述系
10 爭專利之技術特徵不同，參加人以其所舉之「假想例」
11 ，據以主張原證4 與原證5 難以結合，尚不可採。

12 13. 參加人107 年4 月30 日行政訴訟參加人答辯（二）狀第
13 11 至12 頁主張：「原證4 」與「原證5 」，即使再結合
14 「原證6 」或「原證7 」，均無法輕易得到系爭專利請
15 求項2 包含「技術特徵2 」（控制部，針對每個基板處
16 理列而改變處理基板的步驟）、「技術特徵3 」（於上
17 下方向排列設置上述複數個基板處理列）、「技術特徵
18 5 」（上述控制部在部分基板處理列以通常運轉時之步
19 驟處理基板，並同時在其他基板處理列藉由改變處理基
20 板的步驟以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所
21 進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基板）作為一整
22 體的技術手段云云。惟查原證4 圖1 至3 已揭露系爭專
23 利之「基板處理裝置」、「複數個基板處理列」、「複
24 數個處理單元」、「主搬送機構」、「複數個處理單元
25 的種類，在基板處理列之間為相同」等技術特徵。簡單
26 修飾原證4 之處理單元排列方式為不同處理列之處理單

01 元，分別設置於上、下不同階層（如一處理列之處理單
02 元設置在上階層、另一處理列之處理單元設置在下階層
03 ）），即輕易完成系爭專利之「於上下方向排列設置上述
04 複數個基板處理列」（技術特徵3）。原證7第〔0002
05 〕段揭露系爭專利之「試運轉」技術特徵，而系爭專利
06 所屬技術領域中具有通常知識者依據前述原證6第〔
07 0013〕、〔0024〕、〔0034〕段揭露相當於系爭專利之
08 「試運轉」、「控制部，對基板處理列而改變處理基板
09 的步驟」之內容及原證5第〔0046〕段揭露在不同處理
10 室併行進行的通常的成膜工序（相當於系爭專利之「通
11 常運轉」）及條件試出（相當於系爭專利之「試運轉」
12 ），簡單修飾原證4第〔0134〕段所實質揭露之「控制
13 部」控制各處理列以進行之第1處理及第2處理，使原
14 證4之第1處理及第2處理，其中之一者進行「通常運
15 轉」而另一者進行「試運轉」，即能輕易完成系爭專利
16 之「控制部，針對每個基板處理列而改變處理基板的步
17 驟」（技術特徵2）、「在部分基板處理列以通常運轉
18 時之步驟處理基板，並同時在其他基板處理列藉由改變
19 處理基板的步驟以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對
20 基板所進行處理的品質之試運轉時之步驟處理基板」（
21 技術特徵5）技術特徵。是以參加人前述主張之系爭專
22 利請求項2所包含之「技術特徵2」、「技術特徵3」
23 、「技術特徵5」為所屬技術領域中具有通常知識者依
24 原證4至6之內容所能輕易完成，參加人之主張尚不可
25 採。

26 14. 參加人輔佐人於107年6月13日準備程序庭呈開庭簡報

01 第7 至10頁，及參加人訴訟代理人主張：「專利權人是
02 用其自己的機台、自身的瞭解簡易說明Dual Track Sys
03 tem 到底會達到什麼技術功效特徵，有效減少佔地面積
04 ，此部分如系爭專利說明書第6 頁第2 至4 行提到的複
05 數基板處理列重疊的配置於上下方向，可以防止增大佔
06 地」，系爭專利應具有進步性云云。惟查原證4 圖1 至
07 3 揭露一基板處理裝置，具有2 個處理列13，即相當前
08 述參加人主張之「Dual Track System」，原證4 第〔
09 0040〕段揭露2 個處理列13係併設於y 方向，原證4 圖
10 3 (a) 揭露具有設置在上下(z 軸) 方向之2 個階層
11 (原證4 第〔0041〕段揭露圖1、3 之處理單元9 至12
12 係由1 階部分與2 階部分所構成之2 階段結構) 而用以
13 處理基板的處理單元BARC、SC、SD等，是以原證4 揭露
14 之設置在上下(z 軸) 方向之2 個階層，即具有相當於
15 系爭專利之「處理列重疊的配置於上下方向，可以防止
16 增大佔地」之功效，原證4 至6 之組合、原證4 至7 之
17 組合足以證明系爭專利請求項2 不具進步性，已如前述
18 ，前述參加人輔佐人、訴訟代理人之主張，尚不可採。

19 (3) 原證4、8 之組合、原證4、16之組合、原證4、8、16
20 之組合不足以證明系爭專利請求項3 至4 不具進步性，原
21 證4 至6 之組合、原證4 至7 之組合足以證明系爭專利請
22 求項3 至4 不具進步性：

23 1. 系爭專利請求項3 與請求項2 之相較，系爭專利請求項
24 3 係就請求項2 所界定之「一種基板處理裝置……試運
25 轉時之步驟處理基板」技術特徵，更進一步界定「其中
26 ，上述控制部可使各基板處理列中之步驟在各基板處理

01 列間不同，且可使各基板處理列中之步驟在全部基板處
02 理列間相同」技術特徵。原證4 至6 之組合、原證4 至
03 7 之組合足以證明系爭專利請求項2 不具進步性，已如
04 前述。查系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者依據
05 原證4 第〔0134〕段揭露之「一邊之處理列¹³對基板W
06 進行與第1 處理，以其他處理列¹³對基板W 進行與第1
07 處理不同之第2 處理」，簡單修飾原證4 之第1 處理與
08 第2 處理可為不同或相同，即能輕易完成前述系爭專利
09 請求項³ 更進一步界定之技術特徵。是以原證4 至6 之
10 組合、原證4 至7 之組合足以證明系爭專利請求項³ 不
11 具進步性。

12 2. 系爭專利請求項⁴ 依附請求項³，並進一步界定「上述
13 控制部可使全部基板處理列中之步驟為用以在基板形成
14 阻劑膜、及用以對基板實施顯像的步驟」附屬技術特徵
15 。原證4 至6 之組合、原證4 至7 之組合足以證明系爭
16 專利請求項³ 不具進步性，已如前述。查系爭專利所屬
17 技術領域具有通常知識者依原證4 第〔0014〕段揭露「
18 …對基板進行塗佈處理、熱處理及顯像處理之一連串處
19 理的複數處理列」，即相當於前述系爭專利請求項⁴ 之
20 附屬技術特徵。故原證4 至6 之組合、原證4 至7 之組
21 合足以證明系爭專利請求項⁴ 不具進步性。

22 3. 系爭專利請求項³ 與原證4、8、16 比較，同前述系爭
23 專利請求項² 與原證4、8、16 之比較說明，原證4、
24 8、16 未揭露對不同基板分別以「通常運轉時之步驟」
25 及「試運轉時之步驟」同時進行處理之相關技術內容或
26 教示、建議，所屬技術領域中具有通常知識者依據原證

01 4、8、16等先前技術，無法藉由簡單的轉用、置換、
02 修飾等手段而能輕易完成系爭專利之「控制部在部分基
03 板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他
04 基板處理列藉由改變處理基板的步驟以用來使處理單元
05 試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時
06 之步驟處理基板」技術特徵。原證4、8之組合、原證
07 4、16之組合、原證4、8、16之組合不足以證明系爭
08 專利請求項3不具進步性。系爭專利請求項4依附請求
09 項3，包含請求項3之所有技術特徵，故原證4、8之
10 組合、原證4、16之組合、原證4、8、16之組合不足
11 以證明系爭專利請求項4不具進步性。

12 (4)原證4、8之組合、原證4、16之組合、原證4、8、16
13 之組合不足以證明系爭專利請求項6至7不具進步性，原
14 證4至6之組合、原證4至7之組合足以證明系爭專利請
15 求項6至7不具進步性：

16 1.系爭專利請求項6與請求項2之相較，系爭專利請求項
17 6係就請求項2所界定之「一種基板處理裝置……試運
18 轉時之步驟處理基板」技術特徵，更進一步界定「其中
19 ，上述控制部可使部分基板處理列中之步驟為用以在基
20 板形成阻劑膜、及用以對基板實施顯像的步驟之全部，
21 並同時使其他基板處理列中之步驟為用以在基板形成阻
22 劑膜、及用以對基板實施顯像的步驟之一部分」技術特
23 徵。原證4至6之組合、原證4至7之組合足以證明系
24 爭專利請求項2不具進步性，已如前述。查系爭專利所
25 屬技術領域中具有通常知識者依據原證6第〔0034〕段
26 揭露系爭專利之「控制部，對基板處理列而改變處理基

01 板的步驟」及原證6 第〔0034〕段、圖4 揭露可進行全
02 部處理步驟（A）或部分處理步驟（B、C）技術內容
03 ，簡單修飾原證4 第〔0134〕段所實質揭露之「控制部
04 」控制各處理列以進行之第1 處理及第2 處理（參酌原
05 證4 第〔0014〕段揭露之進行塗佈處理、熱處理及顯像
06 處理之一連串處理）為第1 處理為阻劑膜、及用以對基
07 板實施顯像的步驟之全部，第2 處理為形成阻劑膜、及
08 用以對基板實施顯像的步驟之一部分，即能輕易完成前
09 述系爭專利請求項6 更進一步界定之技術特徵。是以原
10 證4 至6 之組合、原證4 至7 之組合足以證明系爭專利
11 請求項6 不具進步性。

12 2. 系爭專利請求項7 依附請求項6，並進一步界定「其中
13 ，上述其他基板處理列中之步驟為用以在基板形成阻劑
14 膜的步驟、或用以對基板實施顯像的步驟之任一者」附
15 屬技術特徵。原證4 至6 之組合、原證4 至7 之組合足
16 以證明系爭專利請求項6 不具進步性，已如前述。查系
17 爭專利所屬技術領域中具有通常知識者依據原證6 第〔
18 0034〕段、圖4 揭露可對基板進行部分處理步驟（B、
19 C）技術內容，簡單修飾原證4 第〔0014〕段揭露「…
20 對基板進行塗佈處理、熱處理及顯像處理之一連串處理
21 」為對基板進行塗佈處理與熱處理（形成阻劑膜）及顯
22 像處理之任一者，即能輕易完成前述系爭專利請求項7
23 之附屬技術特徵。故原證4 至6 之組合、原證4 至7 之
24 組合足以證明系爭專利請求項7 不具進步性。

25 3. 系爭專利請求項6 與原證4、8、16 比較，同前述系爭
26 專利請求項2 與原證4、8、16 之比較說明，原證4、

01 8、16未揭露對不同基板分別以「通常運轉時之步驟」
02 及「試運轉時之步驟」同時進行處理之相關技術內容或
03 教示、建議，所屬技術領域中具有通常知識者依據原證
04 4、8、16等先前技術，無法藉由簡單的轉用、置換、
05 修飾等手段而能輕易完成系爭專利之「控制部在部分基
06 板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他
07 基板處理列藉由改變處理基板的步驟以用來使處理單元
08 試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時
09 之步驟處理基板」技術特徵。原證4、8之組合、原證
10 4、16之組合、原證4、8、16之組合不足以證明系爭
11 專利請求項6不具進步性。系爭專利請求項7依附請求
12 項6，包含請求項6之所有技術特徵，故原證4、8之
13 組合、原證4、16之組合、原證4、8、16之組合不足
14 以證明系爭專利請求項7不具進步性。

15 (5)原證4、8之組合、原證4、16之組合、原證4、8、16
16 之組合不足以證明系爭專利請求項8至9不具進步性，原
17 證4至6之組合、原證4至7之組合足以證明系爭專利請
18 求項8至9不具進步性；

19 1.系爭專利請求項8與請求項2之相較，系爭專利請求項
20 8係就請求項2所界定之「一種基板處理裝置……試運
21 轉時之步驟處理基板」技術特徵，更進一步界定「其中
22 上述控制部可使部分基板處理列進行由種類不同之複
23 數處理所構成的步驟，並同時使其他基板處理列進行由
24 單一處理所構成的步驟」技術特徵。原證4至6之組合
25 及原證4至7之組合足以證明系爭專利請求項2不具進
26 步性，已如前述。查系爭專利所屬技術領域中具有通常

01 知識者依據原證6 第〔0034〕段揭露系爭專利之「控制
02 部，對基板處理列而改變處理基板的步驟」技術特徵及
03 原證6 第〔0034〕段、圖4 揭露可進行全部處理步驟（
04 A）或部分處理步驟（B、C）技術內容，簡單修飾原
05 證4 第〔0134〕段所實質揭露之「控制部」控制各處理
06 列以進行之第1 處理及第2 處理（參酌原證4 第〔0014
07 〕揭露之進行塗佈處理、熱處理及顯像處理之一連串處
08 理），使第1（2）處理為複數處理，第2（1）處理
09 為單一處理，即能輕易完成前述系爭專利請求項8 更進
10 一步界定之技術特徵。是以原證4 至6 之組合、原證4
11 至7 之組合足以證明系爭專利請求項8 不具進步性。

12 2. 系爭專利請求項9 依附請求項8，並進一步界定「上述
13 由單一處理構成的步驟為由對基板塗佈阻劑膜材料的阻
14 劑膜材料塗佈處理、對基板供給顯像液的顯像處理、及
15 對基板進行加熱或冷卻的熱處理中任一處理所構成的步
16 驟」附屬技術特徵。原證4 至6 之組合、原證4 至7 之
17 組合足以證明系爭專利請求項8 不具進步性，已如前述
18 查系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者依據原證
19 6 第〔0034〕段、圖4 揭露可進行部分處理步驟（B、
20 C）技術內容，簡單修飾原證4 第〔0134〕段所實質揭
21 露之「控制部」控制各處理列以進行之第1 處理及第2
22 處理（參酌原證4 第〔0014〕揭露之進行塗佈處理、熱
23 處理及顯像處理之一連串處理），使第1、2 處理其中
24 之一為塗佈處理、熱處理及顯像處理之一任一處理，即
25 能輕易完成前述系爭專利請求項9 之附屬技術特徵。故
26 原證4 至6 之組合、原證4 至7 之組合足以證明系爭專

01 利請求項9 不具進步性。

02 3. 系爭專利請求項8 與原證4 、8 、16比較，同前述系爭

03 專利請求項2 與原證4 、8 、16之比較說明，原證4 、

04 8 、16未揭露對不同基板分別以「通常運轉時之步驟」

05 及「試運轉時之步驟」同時進行處理之相關技術內容或

06 教示、建議，所屬技術領域中具有通常知識者依據原證

07 4 、8 、16等先前技術，無法藉由簡單的轉用、置換、

08 修飾等手段而能輕易完成系爭專利之「控制部在部分基

09 板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他

10 基板處理列藉由改變處理基板的步驟以用來使處理單元

11 試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時

12 之步驟處理基板」技術特徵。原證4 、8 之組合、原證

13 4 、16之組合、原證4 、8 、16之組合不足以證明系爭

14 專利請求項8 不具進步性。系爭專利請求項9 依附請求

15 項8 ，系包含請求項8 之所有技術特徵，故原證4 、8

16 之組合、原證4 、16之組合、原證4 、8 、16之組合不

17 足以證明系爭專利請求項9 不具進步性。

18 (6) 原證4 、8 之組合、原證4 、16之組合、原證4 、8 、16

19 之組合不足以證明系爭專利請求項10至11不具進步性，原

20 證4 至6 之組合、原證4 至7 之組合足以證明系爭專利請

21 求項10至11不具進步性；

22 1. 系爭專利請求項10與請求項2 之相較，系爭專利請求項

23 10係就請求項2 所界定之「一種基板處理裝置……試運

24 轉時之步驟處理基板」技術特徵，更進一步界定「其中

25 ，上述控制部可使部分基板處理列進行由種類不同之複

26 數處理構成的第1 步驟，並同時使其他基板處理列進行

01 由種類不同之複數處理構成且與第1 步驟不同的第2 步
02 驟」技術特徵。原證4 至6 之組合、原證4 至7 之組合
03 足以證明系爭專利請求項2 不具進步性，已如前述。查
04 原證4 第〔0134〕段揭露之「一邊之處理列13對基板W
05 進行與第1 處理，以其他處理列13對基板W 進行與第1
06 處理不同之第2 處理」（參酌原證4 第〔0014〕段揭露
07 之進行塗佈處理、熱處理及顯像處理之一連串處理），
08 即相當於前述系爭專利請求項10更進一步界定之技術特
09 徵。是以原證4 至6 之組合、原證4 至7 之組合足以證
10 明系爭專利請求項10不具進步性。

11 2. 系爭專利請求項11依附請求項10，並進一步界定「上述
12 第1 步驟及上述第2 步驟之至少一者，包含有對基板塗
13 佈阻劑膜材料的阻劑膜材料塗佈處理、對基板供給顯像
14 液的顯像處理、及對基板進行加熱或冷卻的熱處理中之
15 至少一者」附屬技術特徵。原證4 至6 之組合、原證4
16 至7 之組合足以證明系爭專利請求項10不具進步性，已
17 如前述。查原證4 第〔0014〕段揭露「…對基板進行塗
18 佈處理、熱處理及顯像處理之一連串處理的複數處理列
19 」，即相當於前述系爭專利請求項11之附屬技術特徵。
20 故原證4 至6 之組合、原證4 至7 之組合足以證明系爭
21 專利請求項11不具進步性。

22 3. 系爭專利請求項10與原證4 、8 、16比較，同前述系爭
23 專利請求項2 與原證4 、8 、16之比較說明，原證4 、
24 8 、16未揭露對不同基板分別以「通常運轉時之步驟」
25 及「試運轉時之步驟」同時進行處理之相關技術內容或
26 教示、建議，所屬技術領域中具有通常知識者依據原證

01 4、8、16等先前技術，無法藉由簡單的轉用、置換、
02 修飾等手段而能輕易完成系爭專利之「控制部在部分基
03 板處理列以通常運轉時之步驟處理基板，並同時在其他
04 基板處理列藉由改變處理基板的步驟以用來使處理單元
05 試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質之試運轉時
06 之步驟處理基板」技術特徵。原證4、8之組合、原證
07 4、16之組合、原證4、8、16之組合不足以證明系爭
08 專利請求項10不具進步性。系爭專利請求項11依附請求
09 項10，包含請求項10之所有技術特徵，故原證4、8之
10 組合、原證4、16之組合、原證4、8、16之組合不足
11 以證明系爭專利請求項11不具進步性。

12 (三)原證4、6、8之組合、原證4、6、16之組合、原證4、
13 6、8、16之組合、原證4至6之組合、原證4至7之組合
14 是否足以證明系爭專利請求項5、13至14、16至20不具進步
15 性？

16 (1)原證4、6、8之組合、原證4、6、16之組合、原證4
17 、6、8、16之組合不足以證明系爭專利請求項5不具進
18 步性，原證4至6之組合、原證4至7之組合足以證明系
19 爭專利請求項5不具進步性：

20 1.系爭專利請求項5與請求項2之相較，系爭專利請求項
21 5係就請求項2所界定之「一種基板處理裝置……試運
22 轉時之步驟處理基板」技術特徵，更進一步界定「其中
23 ，上述基板處理裝置進一步具備有輸入部，其輸入用以
24 對每個基板處理列設定基板搬送路徑之資訊；上述控制
25 部係根據輸入至上述輸入部之資訊，改變各基板處理列
26 的搬送路徑；輸入至上述輸入部之資訊係特定進行試運

01 轉之處理單元的資訊；上述控制部係根據特定進行試運
02 轉之處理單元的資訊，決定將基板僅搬送至所特定之處
03 理單元的搬送路徑」技術特徵。原證4 至6 之組合、原
04 證4 至7 之組合足以證明系爭專利請求項2 不具進步性
05 ，已如前述。查原證6 第〔0024〕段及圖1 揭露半導體
06 基板處理系統10，其操作部20連接控制裝置19，原證6
07 第〔0034〕段揭露操作部20輸入的資訊包含「所使用處
08 理裝置之種類及順序」，是以操作部20可輸入特定進行
09 試運轉之處理單元之資訊，使控制裝置19據以改變基板
10 處理列之處理基板的步驟及搬運路線，將基板僅搬送至
11 特定之處理單元，原證6 之操作部20即相當於系爭專利
12 之「輸入部」技術特徵，原證6 已揭露前述系爭專利請
13 求項5 更進一步界定之技術特徵。是以原證4 至6 之組
14 合、原證4 至7 之組合足以證明系爭專利請求項5 不具
15 進步性。

16 2. 系爭專利請求項5 與原證4 、6 、8 、16比較，同前述
17 系爭專利請求項2 與原證4 、6 、8 、16之比較說明，
18 原證4 、6 、8 、16未揭露對不同基板分別以「通常運
19 轉時之步驟」及「試運轉時之步驟」同時進行處理之相
20 關技術內容或教示、建議，所屬技術領域中具有通常知
21 識者依據原證4 、6 、8 、16等先前技術，無法藉由簡
22 單的轉用、置換、修飾等手段而能輕易完成系爭專利之
23 「控制部在部分基板處理列以通常運轉時之步驟處理基
24 板，並同時在其他基板處理列藉由改變處理基板的步驟
25 以用來使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理
26 的品質之試運轉時之步驟處理基板」技術特徵。原證4

01 、6、8之組合、原證4、6、16之組合、原證4、6
02 、8、16之組合不足以證明系爭專利請求項5不具進步
03 性。

04 (2)原證4、6、8之組合、原證4、6、16之組合、原證4
05 、6、8、16之組合、原證4至6之組合、原證4至7之
06 組合足以證明系爭專利請求項13至14、16至20不具進步性
07 。

08 1.系爭專利請求項13為一種基板處理裝置，用以處理基板
09 ，其包含以下元件：橫向排列的複數個處理區，具有設
10 置在上下方向之每個階層而用以處理基板的處理單元、
11 和設置在各階層而用以對該階層之處理單元搬送基板
12 的主搬送機構；可在該處理區之相同階層中相鄰接的主搬
13 送機構彼此間交接基板，而在各階層中對基板進行一連
14 串處理；及控制部，控制各主搬送機構，針對每個階層
15 而改變基板相對於各階層處理單元的搬送路徑；在進行
16 試運轉之處理單元的階層中，上述控制部藉由改變基板
17 的搬送路徑使基板僅搬送至進行該試運轉之處理單元，
18 其中，上述控制部可在各階層中分別對基板進行一連串
19 處理之全部，或一連串處理之一部分。

20 2.系爭專利請求項13與原證4比較，原證4圖1至3揭露
21 一基板處理裝置，具有橫向排列的複數個處理區9至12
22 ，原證4圖3(a)揭露具有設置在上下(Z軸)方向
23 之2個階層(原證4第[0041]段揭露圖1、3之處理
24 單元9至12係由1階部分與2階部分所構成之2階段結
25 構)而用以處理基板的處理單元BARC、SC、SD等，故原
26 證4圖1至3揭露系爭專利之「複數個處理區」、「上

01 下方向之階層」、「處理單元」技術特徵，原證4 圖2
02 至3 揭露有各階層共用之搬送機構17、20、22，其當然
03 可用於對各階層處理單元搬送基板，即相當於系爭專利
04 之「設置在各階層而用以對該階層之處理單元搬送基板
05 的主搬送機構」、「相同階層中相鄰接的主搬送機構彼
06 此間交接基板」技術特徵。原證4 第〔0134〕段揭露「
07 一邊之處理列13對基板W 進行與第1 處理，以其他處理
08 列13對基板W 進行與第1 處理不同之第2 處理」即可推
09 知原證4 第〔0134〕段實質揭露一「控制部」以控制複
10 數個處理列13以同時進行第1 處理及第2 處理。

11 3. 系爭專利請求項13與原證5 比較，原證5 第〔0046〕段
12 揭露可在一邊的處理室與另邊的處理室以不同的條件來
13 併行實施成膜，能不停止生產而機動性且效率良好地進
14 行新製程的條件試出，原證5 第〔0015〕段揭露「在基
15 板朝一邊處理室搬送處理期間，可進行另邊處理室相關
16 之維修或條件變更」，原證5 之「條件試出」係具有以
17 試驗、檢查、驗證或確認處理室對基板處理品質為目的
18 之處理程序，原證5 之「條件試出」即相當於系爭專利
19 之「試運轉」技術特徵。

20 4. 系爭專利請求項13與原證6 比較，原證6 第〔0013〕段
21 揭露的「條件試出」為處理裝置對半導體晶圓一邊改變
22 處理條件，一邊試驗性的加以處理，是以原證6 之「條
23 件試出」係具有以試驗、檢查、驗證或確認處理裝置對
24 半導體晶圓處理品質為目的之試驗性處理，即相當於系
25 爭專利之「試運轉」技術特徵，原證6 第〔0024〕段及
26 圖1 揭露半導體基板處理系統10，其操作部20連接控制

01 裝置19，原證6 第〔0034〕段揭露操作部20輸入的資訊
02 包含「所使用處理裝置之種類及順序」，是以操作部20
03 可輸入特定進行試運轉之處理單元之資訊，使控制裝置
04 19據以改變基板處理列之處理基板的步驟及搬運路線，
05 將基板僅搬送至特定之處理單元，是以原證6 第〔0013
06 〕、〔0024〕、〔0034〕段已揭露系爭專利之「控制部
07 對基板處理列而改變基板搬送路徑」、「上述控制部
08 藉由改變基板的搬送路徑使基板僅搬送至進行該試運轉
09 之處理單元」技術特徵。

10 5. 系爭專利請求項13與原證7 比較，原證7 第〔0002〕段
11 揭露「在對基板進行既定處理之基板處理裝置中，會在
12 實際運作前進行用以確認其動作之試驗性運轉（動作測
13 試），例如下述專利文獻1 中，會以修正基板處理裝置
14 所設定之基板處理條件為目的，實際對基板進行塗布形
15 成光阻，曝光處理及顯影處理來作為動作測試」，原證
16 7 之「試驗性運轉」具有以試驗、檢查、驗證或確認基
17 板處理裝置對基板處理的品質為目的之運轉，因此原證
18 7 第〔0002〕段揭露之「試驗性運轉」，即相當於系爭
19 專利之「試運轉」技術特徵。

20 6. 系爭專利請求項13與原證8 比較，原證8 第8 頁第1 至
21 8 行揭露「由於獨立地執行基板處理流程與檢查流程，
22 因此，在基板處理裝置之試運轉時，可執行基板檢查流
23 程，並可將搬入搬入搬出部之例如評定用基板直接搬送
24 至檢查部進行檢查」、「可同時進行基板之檢查流程及
25 處理流程」，原證8 第8 頁第1 至8 行已揭露系爭專利
26 之「試運轉」技術特徵。

01 7. 系爭專利請求項13與原證16比較，原證16摘要揭露一種
02 半導體晶圓處理機器之分配控制系統、原證16說明書第
03 1 欄第34至41行揭露處理系統的安裝、測試、故障排除
04 、維護等成本，亦直接關係到控制系統的複雜性，原證
05 16說明書第2 欄第27至29行揭露分配控制系統另一優點
06 是，各子系統可單獨測試和診斷，而不需整個處理系統
07 進行動作，原證16揭露之測試和診斷之運作，係具有試
08 驗、檢查、驗證或確認子系統運作是否正常為目的，即
09 相當於系爭專利之「試運轉」技術特徵。

10 8. 綜上，原證4 第〔0134〕段及圖1 至3 揭露系爭專利之
11 「複數個處理區」、「上下方向之階層」、「處理單元
12 」、「控制部」等技術特徵，原證4 圖2 至3 揭露有各
13 階層共用之搬送機構17、20、22，即相當於系爭專利之
14 「設置在各階層而用以對該階層之處理單元搬送基板
15 的主搬送機構」、「相同階層中相鄰接的主搬送機構彼此
16 間交接基板」技術特徵。系爭專利請求項13與原證4 之
17 差異為，原證4 未揭露系爭專利之「控制各主搬送機構
18 ，針對每個階層而改變基板相對於各階層處理單元的搬
19 送路徑」、「在進行試運轉之處理單元的階層中，上述
20 控制部藉由改變基板的搬送路徑使基板僅搬送至進行該
21 試運轉之處理單元，其中，上述控制部可在各階層中分
22 別對基板進行一連串處理之全部，或一連串處理之一部
23 分」技術特徵。惟系爭專利所屬技術領域中具有通常知
24 識者，可依前述原證6 第〔0013〕、〔0024〕、〔0034
25 〕段所揭露相當於系爭專利之「控制部，對基板處理列
26 而改變基板搬送路徑」、「上述控制部藉由改變基板的

01 搬送路徑使基板僅搬送至進行該試運轉之處理單元」等
02 內容，簡單修飾原證4 第〔0134〕段所實質揭露之「控
03 制部」以控制各處理列，即能輕易完成系爭專利之「控
04 制各主搬送機構，針對每個階層而改變基板相對於各階
05 層處理單元的搬送路徑」、「在進行試運轉之處理單元
06 的階層中，上述控制部藉由改變基板的搬送路徑使基板
07 僅搬送至進行該試運轉之處理單元」技術特徵。系爭專
08 利所屬技術領域中具有通常知識者依據原證6 第〔0034
09 〕段揭露系爭專利之「控制部，對基板處理列而改變處
10 理基板的步驟」技術特徵及原證6 第〔0034〕段、圖4
11 揭露可進行全部處理步驟（A）或部分處理步驟（B、
12 C）技術內容，簡單修飾原證4 第〔0134〕段所實質揭
13 露之「控制部」控制各處理列以進行之第1 處理及第2
14 處理（參酌原證4 第〔0014〕段揭露之進行塗佈處理、
15 熱處理及顯像處理之一連串處理），使第1（2）處理
16 為一連串處理之全部，第2（1）處理為一連串處理之
17 一部分，即能輕易完成系爭專利之「控制部可在各階層
18 中分別對基板進行一連串處理之全部，或一連串處理之
19 一部分」技術特徵。是以系爭專利請求項13為所屬技術
20 領域中具有通常知識者依原證4、6 之先前技術所能輕
21 易完成。

22 9. 原證4 至8、16與系爭專利均為基板處理裝置之相同技
23 術領域；原證4 摘要揭露以2 個併列處理列以解決一處
24 理列故障之問題，原證5 第〔0015〕段揭露在基板朝一
25 邊處理室搬送處理期間，可進行另邊處理室相關之維修
26 或條件變更，原證6 第〔0013〕段揭露的條件試出為將

01 半導體圓一邊改變處理條件，一邊試驗性的加以處理，
02 原證7 第〔0002〕段揭露在對基板進行既定處理之基板
03 處理裝置中，會在實際運作前進行用以確認其動作之試
04 驗性運轉（動作測試），原證8 第8 頁第1 至8 行揭露
05 基板處理裝置之試運轉時，可執行基板檢查流程，原證
06 16 說明書第2 欄第27 至29 行揭露分配控制系統之各子系
07 統可單獨測試和診斷，而不需整個處理系統進行動作，
08 原證4 至8 、16 與系爭專利均為解決基板處理裝置維修
09 或條件變更、試運轉時之問題，具有所欲解決問題之共
10 通性；原證4 至8 、16 與系爭專利均係基板處理裝置對
11 基板進行成膜、曝光、顯像、研磨之步驟，具有功能或
12 作用上的共通性；原證4 至8 、16 具有明顯之結合動機
13 。系爭專利請求項13 為所屬技術領域中具有通常知識者
14 依原證4 、6 之先前技術所能輕易完成，已如前述。是
15 以原證4 、6 、8 之組合、原證4 、6 、16 之組合、原
16 證4 、6 、8 、16 之組合、原證4 至6 之組合、原證4
17 至7 之組合足以證明系爭專利請求項13 不具進步性。

18 10. 被告107 年1 月4 日行政訴訟答辯書第15 頁理由（4 ）
19 主張：原證6 的半導體基板處理系統10 僅包含單一產線
20 ，非如系爭專利的複數處理列，雖原證6 可在單一產線
21 （單一階層）執行試運轉，但是無法說明原證6 的控制
22 部可在複數階層的情況下，完成系爭專利之「在進行試
23 運轉之處理單元的階層中，上述控制部使基板僅搬送至
24 進行該試運轉之處理單元」（技術特徵18）云云。惟查
25 原證6 的半導體基板處理系統在單一產線執行試運轉，
26 原證6 第〔0013〕、〔0024〕、〔0034〕段揭露系爭專

01 利之「控制部，對基板處理列而改變基板搬送路徑」、
02 「在進行試運轉之處理單元，上述控制部使基板僅搬送
03 至進行該試運轉之處理單元」已如前述。原證4 第〔
04 0134〕段實質揭露「控制部」控制各處理列以進行之第
05 1 處理及第2 處理（二個獨立的產線），原證4 實質揭
06 露「控制部」可控制二個獨立的產線。系爭專利所屬技
07 術領域中具有通常知識者依據前述原證6 第〔0013〕、
08 〔0024〕、〔0034〕段揭露的單一產線執行試運轉技術
09 ，簡單修飾前述原證4 第〔0134〕段揭露之二個獨立產
10 線之任一產線以進行試運轉技術，並無困難，即可輕易
11 完成系爭專利之「在進行試運轉之處理單元的階層中，
12 上述控制部使基板僅搬送至進行該試運轉之處理單元」
13 （技術特徵18），被告之主張尚不可採。

14 11. 系爭專利請求項14與請求項13之相較，系爭專利請求項
15 14係就請求項13所界定之「一種基板處理裝置……基板
16 僅搬送至進行該試運轉之處理單元」技術特徵，更進一
17 步界定「其中，試運轉時之步驟係為了使處理單元試驗
18 、檢查或驗證對基板所進行處理的品質而進行」技術特
19 徵。原證4 、6 、8 之組合、原證4 、6 、16之組合、
20 原證4 、6 、8 、16之組合、原證4 至6 之組合、原證
21 4 至7 之組合足以證明系爭專利請求項13不具進步性，
22 已如前述。查原證5 第〔0046〕揭露之「條件試出」、
23 原證6 第〔0013〕揭露之「條件試出」、原證7 第〔
24 0002〕段揭露之「試驗性運轉」、原證8 第8 頁第1 至
25 8 行之「試運轉」及原證16說明書第2 欄第27至29行揭
26 露分配控制系統之各子系統可單獨測試和診斷，均相當

01 於前述系爭專利請求項14更進一步界定之技術特徵。是
02 以原證4、6、8之組合、原證4、6、16之組合、原
03 證4、6、8、16之組合、原證4至6之組合、原證4
04 至7之組合足以證明系爭專利請求項14不具進步性。

05 12. 系爭專利請求項16與請求項13之相較，系爭專利請求項
06 16係就請求項13所界定之「一種基板處理裝置……基板
07 僅搬送至進行該試運轉之處理單元」技術特徵，更進一
08 步界定「具備有輸入用以針對每個階層設定基板搬送路
09 徑之資訊的輸入部，上述控制部根據輸入至上述輸入部
10 的資訊而改變各階層之搬送路徑，其中，輸入至上述輸
11 入部的資訊，為在各階層中對基板所進行的處理之種類
12 與其次序的相關資訊」技術特徵。原證4、6、8之組
13 合、原證4、6、16之組合、原證4、6、8、16之組
14 合、原證4至6之組合、原證4至7之組合足以證明系
15 爭專利請求項13不具進步性，已如前述。查原證6第〔
16 0024〕段及圖1揭露半導體基板處理系統10，其操作部
17 20連接控制裝置19，原證6第〔0034〕段揭露操作部20
18 輸入的資訊包含「所使用處理裝置之種類及順序」，是
19 以操作部20可輸入特定進行試運轉之處理單元之資訊，
20 使控制裝置19據以改變基板處理列之處理基板的步驟及
21 搬運路線，將基板僅搬送至特定之處理單元，原證6之
22 操作部20即相當於系爭專利之「輸入部」技術特徵，原
23 證6已揭露前述系爭專利請求項16更進一步界定之技術
24 特徵。是以原證4、6、8之組合、原證4、6、16之
25 組合、原證4、6、8、16之組合、原證4至6之組合
26 、原證4至7之組合足以證明系爭專利請求項16不具進

步性。

13. 系爭專利請求項17與請求項16之相較，系爭專利請求項17係就請求項16所界定之「一種基板處理裝置……改變各階層之搬送路徑」技術特徵，更進一步界定「其中，輸入至上述輸入部的資訊，為用以特定進行試運轉之處理單元的資訊；上述控制部係根據特定進行試運轉之處理單元的資訊，決定將基板僅搬送至所特定之處理單元的搬送路徑，其中，試運轉時之步驟係為了使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行處理的品質而進行」技術特徵。原證4、6、8之組合、原證4、6、16之組合、原證4、6、8、16之組合、原證4至6之組合、原證4至7之組合足以證明系爭專利請求項16不具進步性，已如前述。查原證6第〔0013〕段揭露的條件試出為將半導體圓一邊改變處理條件，一邊試驗性的加以處理，即相當於系爭專利之「試運轉」技術特徵，原證6第〔0024〕段及圖1揭露半導體基板處理系統10，其操作部20連接控制裝置19，原證6第〔0034〕段揭露操作部20輸入的資訊包含「所使用處理裝置之種類及順序」，是以操作部20可輸入特定進行試運轉之處理單元之資訊，使控制裝置19據以改變基板處理列之處理基板的步驟及搬運路線，將基板僅搬送至特定之處理單元，原證6第〔0013〕、〔0024〕、〔0034〕段已揭露前述系爭專利請求項17更進一步界定之技術特徵。是以原證4、6、8之組合、原證4、6、16之組合、原證4、6、8、16之組合、原證4至6之組合、原證4至7之組合足以證明系爭專利請求項17不具進步性。

01 14. 系爭專利請求項18與請求項13之相較，系爭專利請求項
02 18係就請求項13所界定之「一種基板處理裝置……基板
03 僅搬送至進行該試運轉之處理單元」技術特徵，更進一
04 步界定「其中，上述處理區包含有塗佈處理區與顯像處
05 理區，上述塗佈處理區具備有對基板塗佈處理液的塗佈
06 處理單元作為上述處理單元，上述顯像處理區具備有對
07 基板供給顯像液的顯像處理單元作為上述處理單元」技
08 術特徵。原證4、6、8之組合、原證4、6、16之組
09 合、原證4、6、8、16之組合、原證4至6之組合、
10 原證4至7之組合足以證明系爭專利請求項13不具進步
11 性，已如前述。查原證4第〔0041〕、〔0044〕段揭露
12 防止反射膜塗佈BARC單元14、旋轉塗佈SC單元15、旋轉
13 顯像SD單元16即相當於前述系爭專利請求項18更進一步
14 界定之技術特徵。是以原證4、6、8之組合、原證4
15 、6、16之組合、原證4、6、8、16之組合、原證4
16 至6之組合、原證4至7之組合足以證明系爭專利請求
17 項18不具進步性。

18 15. 系爭專利請求項19依附請求項18，並進一步界定「其中
19 ，上述控制部可對在上述塗佈處理區之全部階層，將所
20 搬入的基板於在上述塗佈處理單元進行處理後送出至該
21 塗佈處理區之外部，且可對在上述塗佈處理區之部分階
22 層，將所搬入的基板於在上述塗佈處理單元進行處理後
23 送出至該塗佈處理區之外部，並同時對在上述塗佈處理
24 區之其他階層，將所搬入的基板在未搬送至上述塗佈處
25 理單元之情況下送出至該塗佈處理區之外部」附屬技術
26 特徵。原證4、6、8之組合、原證4、6、16之組合

01 　、原證4、6、8、16之組合、原證4至6之組合、原
02 證4至7之組合足以證明系爭專利請求項18不具進步性
03 　，已如前述。系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者
04 依據原證4第〔0134〕段所實質揭露之「控制部」控制
05 各處理列以進行之第1處理及第2處理（參酌原證4第
06 〔0014〕揭露之進行塗佈處理、熱處理及顯像處理之一
07 連串處理），依其製程或其他目的之需要而簡單修飾第
08 1處理及第2處理均包含塗佈處理，或僅其中之一包含
09 塗佈處理並控制搬送機構將需進行塗佈處理之基板搬送
10 至塗佈處理單元（無需進行塗佈處理之基板，當然無須
11 搬送至塗佈處理單元），即能輕易完成前述系爭專利請
12 求項19之附屬技術特徵。故原證4、6、8之組合、原
13 證4、6、16之組合、原證4、6、8、16之組合、原
14 證4至6之組合、原證4至7之組合足以證明系爭專利
15 請求項19不具進步性。

16 16. 系爭專利請求項20依附請求項18，並進一步界定「其中
17 　，上述控制部可對在上述顯像處理區之全部階層，將所
18 搬入的基板於在上述顯像處理單元進行處理後送出至該
19 顯像處理區之外部，並且可對在上述顯像處理區之部分
20 階層，將所搬入的基板於在上述顯像處理單元進行處理
21 後送出至該顯像處理區之外部，並同時對在上述顯像處
22 理區之其他階層，將所搬入的基板在未搬送至上述顯像
23 處理單元之情況下送出至該顯像處理區之外部」附屬技
24 術特徵。原證4、6、8之組合、原證4、6、16之組
25 合、原證4、6、8、16之組合、原證4至6之組合、
26 原證4至7之組合足以證明系爭專利請求項18不具進步

01 性，已如前述。系爭專利所屬技術領域中具有通常知識
02 者依據原證4 第〔0134〕段所實質揭露之「控制部」控
03 制各處理列以進行之第1 處理及第2 處理（參酌原證4
04 第〔0014〕段揭露之進行塗佈處理、熱處理及顯像處理
05 之一連串處理），依其製程或其他目的之需要而簡單修
06 飾第1 處理及第2 處理均包含顯像處理，或僅其中之一
07 包含顯像處理並控制搬送機構將需進行顯像處理之基板
08 搬送至顯像處理單元（無需進行顯像處理之基板，當然
09 無須搬送至顯像處理單元），即能輕易完成前述系爭專
10 利請求項20之附屬技術特徵。故原證4、6、8之組合
11、原證4、6、16之組合、原證4、6、8、16之組合
12、原證4至6之組合、原證4至7之組合足以證明系爭
13 專利請求項20不具進步性。

14 (四)原處分及訴願決定是否違反專利法第73條第4項之規定？

15 (1)原告106年9月25日行政訴訟準備(一)狀第30至31頁雖
16 主張：系爭專利有效性攻防手段中所爭執之裝置「異常」
17、「故障」、「修復後」、「故障排除」等與系爭專利申
18 請專利範圍所記載之「試運轉」的關係甚為緊密，此關係
19 到熟習系爭專利技藝人士是否能思及「試運轉」的運作及
20 內容，原處分及訴願決定直接以舉發理由與答辯理由中多
21 次爭執之裝置「異常」、「故障」、「修復後」、「故障
22 排除」與「試運轉」的關係均非本舉發案所應審究者，以
23 及試運轉之處理單元是否是一種實施形態等，皆非系爭專
24 利申請專利範圍之記載，及後續原告於104年10月20日對
25 此提出補充證據(原證12)，亦非本舉發案應審究者，而
26 未對此相關之證據加以審酌，違反專利法第73條第4項規

01 定云云。

02 (2)按系爭專利核准時之專利法第73條第4項規定：舉發人補
03 提理由或證據，應於舉發後一個月內為之。但在舉發審定
04 前提出者，仍應審酌之。經查，原處分係以系爭專利說明
05 書及申請專利範圍之記載為主，並參酌外部證據（舉發附
06 件1、2），解釋系爭專利之「試運轉」之意涵，並據以
07 做為舉發證據是否揭示系爭專利之「試運轉」之基礎（見
08 原處分書第8頁(六)1(2)）。並審認兩造爭執之裝置「異常
09 」、「故障」、「修復後」、「故障排除」與試運轉的關
10 係及後續衍生內容皆非系爭專利申請專利範圍之記載及後
11 續原告104年10月20日提出補充證據（原證12），亦非本
12 舉發案應審究者（見原處分書第30頁28(1)、(2)）。原處分
13 已就原告爭執裝置之「異常」等4名詞與試運轉之關係及
14 所提補充證據（原證12）等予以審酌後，認定其皆非系爭
15 專利申請專利範圍之記載，非為原處分所應審究者，故原
16 處分並無漏未審酌之情形，原告主張尚不可採。

17 (3)再查，原告主張之裝置「異常」、「故障」、「修復後」
18 、「故障排除」與系爭專利說明書第18頁之「在以處理品
19 質之確認和試驗、或處理單元之試運轉等為目的之下，則
20 為試運轉時之步驟」記載及系爭專利請求項2對「試運轉
21 」、「試運轉」之限定為「使處理單元試驗、檢查或驗證對基板所進行
22 處理的品質」比較，前者係為設備功能不正常狀態及其處
23 理，後者係與確認處理品質相關，前後二者明顯不同。是
24 以裝置「異常」、「故障」、「修復後」、「故障排除」
25 與系爭專利之「試運轉」並無直接關聯性，自難謂其關係
26 甚為緊密，原告主張尚不可採。

01 五、綜上所述，原證4 至6 之組合、原證4 至7 之組合足以證明
02 系爭專利請求項2 至4 、6 至11不具進步性。原證4 至6 之
03 組合、原證4 至7 之組合足以證明系爭專利請求項5 不具進
04 步性。原證4 、6 、8 之組合、原證4 、6 、16之組合、原
05 證4 、6 、8 、16之組合、原證4 至6 之組合、原證4 至7
06 之組合足以證明系爭專利請求項13至14、16至20不具進步性
07 。系爭專利請求項2 至11、13至14、16至20違反100 年專利
08 法第22條第2 項規定，具有應撤銷之事由，原處分關於「請
09 求項2 至11、13至14、16至20舉發不成立」部分之處分，有
10 所違誤，訴願決定予以維持，亦有未洽，本件原告已於本院
11 審理程序中向被告申請更正請求項2 、3 、5 、6 、8 、10
12 、13、14、16至18，並經被告准予更正，惟本件經兩造充分
13 攻防後，本院仍認為更正後之請求項不具進步性，且案件事
14 證已臻明確，原告訴請撤銷訴願決定及原處分關於上開請求
15 項舉發不成立部分，並命被告應作成「請求項2 至11、13至
16 14、16至20舉發成立，應予撤銷」之處分，為有理由，應予
17 准許，爰撤銷改判如主文第一、二項所示。

18 六、本件事證已明，兩造其餘攻擊及防禦方法，均與本件判決結
19 果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

20 據上論結，本件原告之訴為有理由，依智慧財產案件審理法第1
21 條、行政訴訟法第200 條第3 款、第98條第1 項前段，判決如主
22 文。

23 中 華 民 國 108 年 6 月 27 日

24 智慧財產法院第二庭

25 審判長法官 汪漢卿

26 法官 曾啟謀

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。
上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所 需 要 件
(一) 符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1. 上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2. 稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3. 專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二) 非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審	1. 上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2. 稅務行政事件，具備會計師資格者。

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

訴訟代理人	3. 專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4. 上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中 華 民 國 108 年 6 月 27 日
書記官 郭宇修